

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 10 月 13 日 (13.10.2005)

PCT

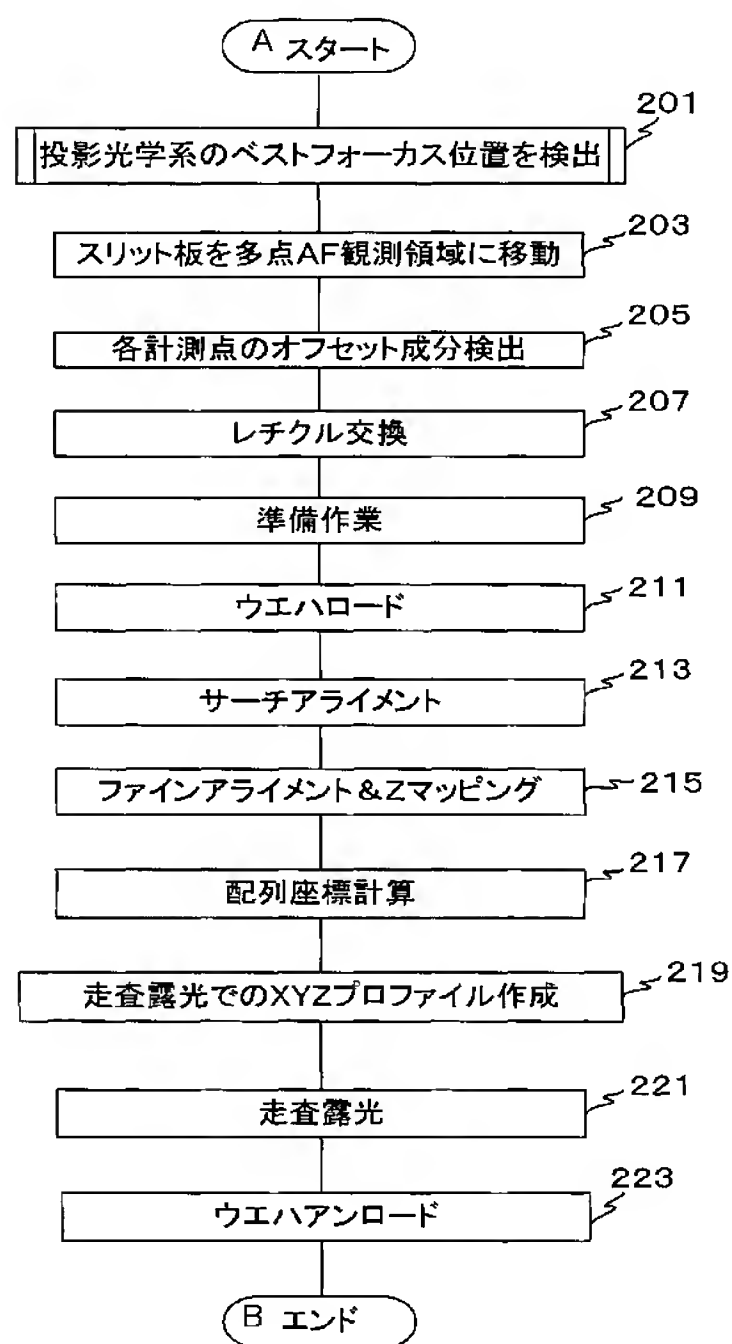
(10) 国際公開番号
WO 2005/096354 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01L 21/027, G03F 7/20 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/006071
- (22) 国際出願日: 2005 年 3 月 30 日 (30.03.2005) (72) 発明者; および
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 馬込 伸貴 (MAGOME, Nobutaka) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP). 水谷 英夫 (MIZUTANI, Hideo) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP). 日高 康弘 (HIDAKA,
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-099530 2004 年 3 月 30 日 (30.03.2004) JP

[続葉有]

(54) Title: EXPOSURE APPARATUS, EXPOSURE METHOD, DEVICE MANUFACTURING METHOD, AND SURFACE SHAPE DETECTING DEVICE

(54) 発明の名称: 露光装置、露光方法及びデバイス製造方法、並びに面形状検出装置



(57) Abstract: At subroutine 201 and at step 205, the best focus plane of a projection optical system (PL) and the offset component of a multipoint AF system are detected as calibration information. During measurement of an alignment mark by means of an alignment system (ALG) at step 215, information (Z map) on the shape of the surface to be exposed of the wafer is extracted by the multipoint AF system. At step 219, an XY position command profile of the wafer stage during scanning exposure and Z-position command profile concerning the position command (Z, θ_x , θ_y) of autofocus/leveling control are created. At step 221, while conducting open control according to the position command, scanning exposure is performed.

(57) 要約: サブルーチン 201 及びステップ 205 において、投影光学系 PL の最良結像面及び多点 AF 系のオフセット成分を較正情報として検出する。ステップ 215 でのアライメント系 ALG によるウエハアライメントマークの計測中に、多点 AF 系により、ウエハの露光対象面の面形状に関する情報 (Z マップ) を検出し、ステップ 219 では、走査露光中におけるウエハステージの XY の位置指令プロファイルとともに、オートフォーカス・レベリング制御に関する位置指令 (Z, θ_x , θ_y) に関する Z 位置指令プロファイルを作成し、ステップ 221 においてその位置指令に基づいてオープン制御を行いつつ、走査露光を行う。

- A... START
201... DETECT BEST FOCUS POSITION OF PROJECTION OPTICAL SYSTEM
203... MOVE SLIT PLATE TO MULTIPOINT AF OBSERVATION AREA
205... DETECT OFFSET COMPONENT OF EACH MEASUREMENT POINT
207... EXCHANGE RETICLE
209... PREPARATION
211... LOAD WAFER
213... SEARCH ALIGNMENT
215... FINE ALIGNMENT & Z MAPPING
217... CALCULATE ARRAY COORDINATE
219... CREATE XYZ PROFILE FOR SCANNING EXPOSURE
221... SCANNING EXPOSURE
223... UNLOAD WAFER
B... END



Yasuhiro) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内
3丁目2番3号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 立石 篤司 (TATEISHI, Atsuji); 〒2060035 東
京都多摩市唐木田一丁目53番地9 唐木田センター
ビル 立石国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

露光装置、露光方法及びデバイス製造方法、並びに面形状検出装置 技術分野

- [0001] 本発明は、露光装置、露光方法及びデバイス製造方法、並びに面形状検出装置に係り、さらに詳しくは、投影光学系を介して物体を露光する露光装置及び露光方法、及び前記露光装置又は露光方法を用いるデバイス製造方法、並びに前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出する面形状検出装置に関する。

背景技術

- [0002] 従来より、半導体素子(集積回路)、液晶表示素子等の電子デバイスを製造するリソグラフィ工程では、マスク又はレチクル(以下、「レチクル」と総称する)のパターンの像を、投影光学系を介して、レジスト(感光剤)が塗布されたウエハ又はガラスプレート等感光性の基板(以下、「基板」又は「ウエハ」と呼ぶ)上の各ショット領域に転写する投影露光装置が使用されている。この種の投影露光装置としては、従来、ステップ・アンド・リピート方式の縮小投影露光装置(いわゆるステッパ)が多用されていたが、最近ではレチクルとウエハとを同期走査しつつ露光を行うステップ・アンド・スキャン方式の投影露光装置(いわゆるスキャニング・ステッパ)も注目されている。
- [0003] この種の露光装置を用いて露光を行う際には、デフォーカスに起因する露光不良の発生を極力抑制するために、投影光学系の光軸方向に関する基板の位置を、焦点位置検出系(フォーカス検出系)により検出し、その検出結果に基づいて、基板上の露光領域(露光光が照明される領域)を投影光学系の最良結像面の焦点深度の範囲内に位置させる、いわゆるオートフォーカス・レベリング制御を行っている。通常、このような焦点位置検出系としては、斜入射方式の多点焦点位置検出系(以下、「多点AF系」と呼ぶ)が採用されている(例えば、特許文献1、特許文献2等参照)。
- [0004] しかしながら、上記投影露光装置においては、投影光学系の開口数(NA)が大きければ大きいほど解像度が向上するため、最近では、投影光学系に用いられるレンズ、特に投影光学系を構成する最も像面側のレンズの口径が大きくなってきており、このレンズの大口径化に伴って該レンズと基板との間隔(いわゆるワーキングディスタ

ンス)が狭くなり、この結果、上記多点AF系を配置することが困難になってきている。

[0005] 特許文献1:特開平6-283403号公報

特許文献2:米国特許第5,448,332号明細書

発明の開示

課題を解決するための手段

[0006] 本発明は、上記事情の下になされたもので、第1の観点からすると、投影光学系を介して物体を露光する露光装置であって、前記投影光学系の光軸方向及びその光軸に直交する平面内の2次元方向を含む少なくとも3自由度方向に、前記物体を保持して移動可能で、前記物体の前記光軸方向に関する位置を調整可能なステージと;前記光軸方向に関する前記ステージの位置情報を検出する第1位置検出装置と;前記光軸に直交する平面内における前記ステージの位置情報を検出する第2位置検出装置と;前記露光に先立って、前記ステージに保持された前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出する面形状検出系と;前記物体に対する露光を行う際に、前記面形状検出系の検出結果と前記第1及び第2位置検出装置の検出結果とに基づいて前記ステージを駆動することにより、前記物体の露光対象面の面位置を調整する調整装置と;を備える露光装置である。

[0007] これによれば、露光に先立って、ステージに保持された物体の露光対象面の面形状に関する情報を面形状検出系により検出しておき、物体に対する露光を行う際には、調整装置により、面形状検出系により検出された露光対象面の面形状に関する情報(面形状検出系の検出結果)と第1及び第2位置検出装置の検出結果とに基づいてステージ上の物体の面位置が調整される。従って、露光の際に、投影光学系の光軸方向に関する物体の位置を、焦点位置検出系により検出せずとも、露光中の物体上の露光領域(露光光が照明される領域)を投影光学系の最良結像面の焦点深度の範囲内に位置させることができる。

[0008] 本発明は、第2の観点からすると、投影光学系を介して物体を露光する露光方法であって、露光に先立って、前記投影光学系の光軸方向に関する前記物体の露光対象面の面形状に関する情報とともに前記光軸方向に関する前記物体の基準位置に関する情報を検出する検出工程と;前記検出結果に基づいて、前記物体の露光対

象面の面位置を調整しつつ露光を行う露光工程と;を含む露光方法である。

- [0009] これによれば、露光に先立って投影光学系の光軸方向に関する物体の露光対象面の面形状に関する情報とともに光軸方向に関する物体の基準位置に関する情報を検出しておき、露光の際に、その露光対象面の面形状に関する情報及び光軸方向に関する物体の基準位置に関する情報に基づいてステージ上の物体の面位置を調整する。従って、投影光学系の光軸方向に関する物体の位置を、焦点位置検出系により検出せずとも、露光中の物体上の露光領域(露光光が照明される領域)を投影光学系の最良結像面の焦点深度の範囲内に位置させることができる。
- [0010] 本発明は、第3の観点からすると、物体を保持可能で、所定の方法に移動可能なステージと;前記ステージの移動によりそのステージに保持された前記物体が横切る帯状の領域に照明光を照射する照射系と;前記帯状の領域を前記物体が横切る際のその物体の露光対象面からの前記照明光の反射光を受光する受光系と;前記受光系における反射光の受光位置の基準位置からの位置ずれ量に基づいて、前記物体の面形状に関する情報を検出する検出装置と;を備える面形状検出装置である。
- [0011] これによれば、移動中の物体が横切る帯状の領域に対し照射される照射光が物体面で反射することによって生じる反射光を受光して、その受光位置の基準位置からの位置ずれ量に基づいて物体の面形状を非接触に検出することができる。
- [0012] また本発明は、第4の観点からすると、露光対象の物体を保持可能で、所定の方法に移動可能なステージと;前記ステージの移動によりそのステージに保持された前記物体が横切る帯状の領域に照明光を照射する照射系と、前記帯状の領域を前記物体が横切る際のその物体の露光対象面からの前記照明光の反射光を受光する受光系とを有し、前記受光系の出力に基づいて、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出する検出装置と;前記帯状領域を前記物体が横切るように前記ステージを制御するとともに、前記帯状領域を前記物体が一度横切ることによって得られる、前記物体の露光対象面のほぼ全域の面形状の情報に基づいて、前記物体の露光対象面の面位置調整を行う制御装置と;を備える露光装置である。
- [0013] これによれば、物体の移動中に物体の露光対象面のほぼ全域の面形状に関する情報を短時間に取得することができる。

[0014] また、リソグラフィ工程において、本発明の露光装置を用いて、物体上にデバイスパターンを転写することにより、より高集積度のマイクロデバイスを生産性良く製造することができる。従って、本発明は、更に別の観点からすると、本発明の露光装置を用いるリソグラフィ工程を含むデバイス製造方法であるとも言える。同様に、リソグラフィ工程において、本発明の露光方法を用いて、物体上にデバイスパターンを転写することにより、より高集積度のマイクロデバイスを生産性良く製造することができる。従って、本発明は更に別の観点からすると、本発明の露光方法を用いるリソグラフィ工程を含むデバイス製造方法であるとも言える。

図面の簡単な説明

[0015] [図1]本発明の一実施形態に係る露光装置の構成を概略的に示す図である。

[図2]ウェハステージを示す斜視図である。

[図3]空間像計測装置を用いてレチクル上の計測マークの空間像を計測しているときの様子を示す図である。

[図4]多点AF系を用いてウェハの露光対象面の面形状を計測しているときの様子を示す図である。

[図5]多点AF系の計測点であるスリット像の配置と計測領域との位置関係を示す図である。

[図6]図1の一方のRA検出系12Aの近傍を拡大して示す図である。

[図7]図1の露光装置の制御系の主要な構成を示すブロック図である。

[図8(A)]投影光学系の光軸上のベストフォーカス位置を原点とする座標系と、多点AF系の計測領域の中心を原点とする座標系とを示す図である。

[図8(B)]露光領域内におけるベストフォーカス位置の計測点を示す図である。

[図8(C)]多点AF系における各計測点でのオフセット成分の一例を示す図である。

[図9]本発明の一実施形態の露光装置における露光動作の際の主制御装置の処理アルゴリズムを示すフローチャートである。

[図10]投影光学系のベストフォーカス位置検出のサブルーチンの処理手順を示すフローチャートである。

[図11(A)]露光対象のウェハWの一例を示す上面図である。

[図11(B)]図11(A)のウェハWのA-A'断面に関するZマップより得られたウェハの面形状を示す連続値関数の一例を示す図である。

[図12(A)]他の面形状検出装置の構成の一例を示す斜視図である。

[図12(B)]図12(A)の面形状検出装置の近傍を示す上面図である。

[図12(C)]照射領域SLを示す拡大図である。

[図13]ウェハの露光対象面の面形状を検出するための干渉計システムの概略的な構成を示す図である。

[図14]本発明に係るデバイス製造方法の実施形態を説明するためのフローチャートである。

[図15]図14のステップ804の詳細を示すフローチャートである。

発明を実施するための最良の形態

[0016] 本発明の一実施形態を図1～図11(B)に基づいて説明する。図1には、本発明の一実施形態に係る露光装置100の概略構成が示されている。この露光装置100は、ステップ・アンド・スキャン方式の投影露光装置(スキャニング・ステッパ(スキャナとも呼ばれる))である。

[0017] この露光装置100は、光源及び照明光学系(後述する可動レチクルブラインド等)を含み、エネルギービームとしての照明光(露光光)ILによりレチクルRを照明する照明系10、レチクルRを保持するレチクルステージRST、投影ユニットPU、ウェハWが載置されるウェハステージWST、前記レチクルステージRST及び前記投影ユニットPUなどが搭載されたボディ(図1ではその一部を図示)及びこれらの制御系等を備えている。

[0018] 前記照明系10は、例えば特開2001-313250号公報及びこれに対応する米国特許出願公開第2003/0025890号明細書などに開示されるように、光源、オプティカルインテグレータ等を含む照度均一化光学系、照明系開口絞り、ビームスプリッタ、リレーレンズ、可変NDフィルタ、レチクルブラインド(固定レチクルブラインド及び可動レチクルブラインド)等(いずれも不図示)を含んで構成されている。この照明系10では、主制御装置20の制御の下、回路パターン等が描かれたレチクルR上でX軸方向(図1における紙面内左右方向)に細長く伸びるスリット状の照明領域(レチクル

ブラインドで規定された領域)を照明光ILによりほぼ均一な照度で照明する。ここで、照明光ILとしては、一例としてArFエキシマレーザ光(波長193nm)が用いられている。また、オプティカルインテグレータとしては、フライアイレンズ、ロッドインテグレータ(内面反射型インテグレータ)あるいは回折光学素子などを用いることができる。なお、照明系10を、例えば特開平6-349701号公報及びこれに対応する米国特許第5,534,970号などに開示されるような照明系と同様に構成しても良い。本国際出願で指定した指定国(又は選択した選択国)の国内法令が許す限りにおいて、上記各公報及び対応する米国特許出願公開明細書又は米国特許における開示を援用して本明細書の記載の一部とする。

[0019] 前記レチクルステージRSTは、不図示のレチクルベース上に、その底面に設けられた不図示のエアベアリングなどによって例えば数 μ m程度のクリアランスを介して浮上支持されている。このレチクルステージRST上には、レチクルRが、例えば真空吸着(又は静電吸着)により固定されている。レチクルステージRSTは、ここでは、リニアモータ等を含むレチクルステージ駆動部RSC(図1では不図示、図7参照)により、後述する投影光学系PLの光軸AXに垂直なXY平面内で2次元的に(X軸方向、Y軸方向及びXY平面に直交するZ軸回りの回転方向(θ_z 方向)に)微小駆動可能であるとともに、不図示のレチクルベース上を所定の走査方向(ここでは、図1における紙面直交方向であるY軸方向とする)に指定された走査速度で駆動可能となっている。

[0020] レチクルステージRSTのステージ移動面内の位置は、レチクルレーザ干渉計(以下、「レチクル干渉計」という)16によって移動鏡15を介して例えば0.5~1nm程度の分解能で常時検出されている。この場合、後述する投影ユニットPUを構成する鏡筒40の側面に固定された固定鏡14を基準として位置計測が行われる。実際には、レチクルステージRST上にはY軸方向に直交する反射面を有するY移動鏡とX軸方向に直交する反射面を有するX移動鏡とが設けられ、これらの移動鏡に対応してレチクルY干渉計とレチクルX干渉計とが設けられ、更にこれに対応してX軸方向位置計測用の固定鏡とY軸方向位置計測用の固定鏡とが設けられているが、図1ではこれらが代表的に移動鏡15、レチクル干渉計16、固定鏡14として示されている。レチクルY干渉計とレチクルX干渉計の一方、例えばレチクルY干渉計は測長軸が2軸の干渉

計であり、このレチクルY干渉計の計測値に基づきレチクルステージRSTのY位置に加え θ_z 方向の回転も計測できるようになっている。なお、例えば、レチクルステージRSTの端面を鏡面加工して反射面(移動鏡15の反射面に相当)を形成しても良い。また、レチクルステージRSTの走査方向(本実施形態ではY軸方向)の位置検出に用いられるX軸方向に延びた反射面の代わりに、少なくとも1つのコーナキューブ型ミラー(例えばレトロリフレクタ)を用いても良い。

[0021] レチクル干渉計16の計測値は、主制御装置20に送られている。主制御装置20は、レチクル干渉計16の計測値に基づいてレチクルステージ駆動部RSC(図7参照)を介してレチクルステージRSTを駆動制御する。

[0022] 前記投影ユニットPUは、レチクルステージRSTの図1における下方でボディの一部を構成する鏡筒定盤38にフランジFLG1を介して支持されている。この投影ユニットPUは、円筒状でその外周部の下端部近傍にフランジFLG1が設けられた鏡筒40と、該鏡筒40に保持された複数の光学素子から成る投影光学系PLとによって構成されている。

[0023] 前記投影光学系PLとしては、例えばZ軸方向の共通の光軸AXを有する複数のレンズ(レンズエレメント)から成る屈折光学系が用いられている。この投影光学系PLは、例えば両側テレセントリックな光学系で所定の投影倍率(例えば1/4倍又は1/5倍)を有する縮小光学系である。このため、照明系10からの照明光ILによってレチクルRが照明されると、このレチクルRを通過した照明光ILにより、投影光学系PLを介してその照明領域(照明光ILの照射領域)内のレチクルRの例えば回路パターンの縮小像(回路パターンの一部の縮小像)が、表面にレジスト(感光剤)が塗布されたウエハW上に形成される。

[0024] 本実施形態の露光装置100では、液浸法を適用した露光が行われるため、開口数NAが増大することに伴いレチクル側の開口が大きくなる。このため、レンズのみで構成する屈折光学系においては、ペッツヴァルの条件を満足することが困難となり、投影光学系が大型化する傾向にある。かかる投影光学系の大型化を避けるために、ミラーとレンズとを含んで構成される反射屈折系(カタディ・オプトリック系)を用いても良い。

- [0025] また、露光装置100では、投影光学系PLを構成する最も像面側(ウエハW側)のレンズ(以下、「先端レンズ」という)91の近傍には、液体給排システム132を構成する液体供給ノズル51Aと、液体回収ノズル51Bとが設けられている。液体供給ノズル51Aと、液体回収ノズル51Bは、鏡筒定盤38に保持されており、その先端が、後述するウエハステージWSTと対向するように配置されている。
- [0026] 前記液体供給ノズル51Aには、その一端が液体供給装置131A(図1では不図示、図7参照)に接続された不図示の供給管の他端が接続されており、前記液体回収ノズル51Bには、その一端が液体回収装置131B(図1では不図示、図7参照)に接続された不図示の回収管の他端が接続されている。
- [0027] 前記液体供給装置131Aは、液体のタンク、加圧ポンプ及び温度制御装置並びに供給管に対する液体の供給・停止を制御するためのバルブ等を含んで構成されている。バルブとしては、例えば液体の供給・停止のみならず、流量の調整も可能となるように流量制御弁を用いることが望ましい。前記温度制御装置は、液体タンク内の液体の温度を、露光装置本体が収納されているチャンバ(不図示)内の温度と同程度の温度に調整する。
- [0028] なお、液体を供給するためのタンク、加圧ポンプ、温度制御装置、バルブなどは、その全てを露光装置100で備えている必要はなく、少なくとも一部を露光装置100が設置される工場などの設備で代替することもできる。
- [0029] 前記液体回収装置131Bは、液体のタンク及び吸引ポンプ並びに回収管を介した液体の回収・停止を制御するためのバルブ等を含んで構成されている。バルブとしては、前述した液体供給装置131A側のバルブに対応して流量制御弁を用いることが望ましい。
- [0030] なお、液体を回収するためのタンク、吸引ポンプ、バルブなどは、その全てを露光装置100で備えている必要はなく、少なくとも一部を露光装置100が設置される工場などの設備で代替することもできる。
- [0031] 上記の液体としては、ここでは、ArFエキシマレーザ光(波長193nmの光)が透過する超純水(以下、特に必要な場合を除いて、単に「水」と記述する)を用いるものとする。超純水は、半導体製造工場等で容易に大量に入手できるとともに、ウエハ上の

フォトリソグロフや光学レンズ等に対する悪影響がないという利点がある。また、超純水は環境に対する悪影響がないうえ、不純物の含有量が極めて少ないため、ウェハWの表面及び先端レンズ91の表面をも洗浄する作用も期待できる。

[0032] ArFエキシマレーザー光に対する水の屈折率 n は、ほぼ1.44である。この水の中では、照明光ILの波長は、 $193\text{nm} \times 1/n = \text{約}134\text{nm}$ に短波長化される。

[0033] 前記液体供給装置131A及び液体回収装置131Bは、それぞれコントローラを具備しており、それぞれのコントローラは、主制御装置20によって制御されるようになっている(図7参照)。液体供給装置131Aのコントローラは、主制御装置20からの指示に応じ、供給管に接続されたバルブを所定開度で開き、液体供給ノズル51Aを介して先端レンズ91とウェハWとの間に水を供給する。また、このとき、液体回収装置131Bのコントローラは、主制御装置20からの指示に応じ、回収管に接続されたバルブを所定開度で開き、液体回収ノズル51Bを介して先端レンズ91とウェハWとの間から液体回収装置131B(液体のタンク)の内部に水を回収する。このとき、主制御装置20は、先端レンズ91とウェハWとの間に液体供給ノズル51Aから供給される水の量と、液体回収ノズル51Bを介して回収される水の量とが常に等しくなるように、液体供給装置131Aのコントローラ、液体回収装置131Bのコントローラに対して指令を与える。そのため、先端レンズ91とウェハWとの間には常に一定量の水 L_q (図1参照)が保持される。この場合、先端レンズ91とウェハWとの間に保持された水 L_q は、常に入れ替わっている。

[0034] 上記の説明から明らかなように、本実施形態の液体給排システム132は、上記液体供給装置131A、液体回収装置131B、供給管、回収管、液体供給ノズル51A及び液体回収ノズル51B等を含んで構成された、局所液浸の液体給排システムである。

[0035] なお、上記の説明では、その説明を簡単にするため、液体供給ノズルと液体回収ノズルとがそれぞれ1つずつ設けられているものとしたが、これに限らず、例えば、国際公開第99/49504号パンフレットに開示されるように、ノズルを多数有する構成を採用することとしても良い。要は、投影光学系PLを構成する最下端の光学部材(先端レンズ)91とウェハWとの間に液体を供給することができるのであれば、その構成はいかなるものであっても良い。

- [0036] 前記ウェハステージWSTは、図1に示されるように、投影ユニットPUの下方に水平に配置されたステージベースBSの上面に、その底面に設けられた複数のエアベアリングを介して非接触で浮上支持されている。このウェハステージWST上に、ウェハホルダ70を介してウェハWが真空吸着(又は静電吸着)によって固定されている。前記ステージベースBSの+Z側の面(上面)は、その平坦度が非常に高くなるように加工されており、この面がウェハステージWSTの移動基準面であるガイド面となっている。
- [0037] 前記ウェハステージWSTは、投影光学系PLの図1における下方で、リニアモータ(あるいは平面モータ)などのアクチュエータを含むウェハステージ駆動部WSC(図1では不図示、図7参照)によって上記ガイド面に沿ってXY面内(θ_z 含む)で駆動され、Z軸方向、 θ_x 方向(X軸回りの回転方向)、 θ_y 方向(Y軸回りの回転方向)の3自由度方向に微小駆動される。
- [0038] 前記ウェハホルダ70は、図2に示されるように、板状の本体部70Aと、該本体部70Aの上面に固定されその中央にウェハWの直径より0.1~1mm程度直径が大きな円形開口が形成された補助プレート72とを備えている。この補助プレート72の円形開口内部の領域には、多数のピンが配置されており、その多数のピンによってウェハWが支持された状態で真空吸着されている。この場合、ウェハWが真空吸着された状態では、そのウェハWの表面と補助プレート72の表面との高さがほぼ同一の高さとなるように設定されている。
- [0039] また、補助プレート72には、その一部に矩形状の開口が形成され、その開口内に基準マーク板FMが嵌め込まれている。基準マーク板FMはその表面が、補助プレート72と同一面とされている。この基準マーク板FMの表面には、少なくとも一対のレチクルアライメント用の第1基準マーク WM_1 , WM_2 (図2では不図示、図6参照)と、これらの第1基準マーク WM_1 , WM_2 に対して既知の位置関係にあるオフアクシスアライメント系のベースライン計測用の第2基準マーク(不図示)などが形成されている。
- [0040] 図1に戻り、前記ウェハステージWSTのXY面内に関する位置情報は、ウェハステージWSTの上部に固定された移動鏡17XYに測長ビームを照射するウェハレーザ干渉計(以下、「ウェハ干渉計」という)18によって、例えば0.5~1nm程度の分解能

で常時検出されている。このウェハ干渉計18は、鏡筒定盤38に吊り下げ状態で固定されており、投影ユニットPUを構成する鏡筒40の側面に固定された固定鏡29XYの反射面を基準とする移動鏡17XYの反射面の位置情報をウェハステージWSTのXY平面内の位置情報として計測する。

[0041] 実際には、ウェハステージWST上には、図2に示されるように、実際には、走査方向であるY軸方向に直交する反射面を有するY移動鏡17Yと非走査方向であるX軸方向に直交する反射面を有するX移動鏡17Xとが設けられ、これに対応してレーザ干渉計及び固定鏡も、X軸方向位置計測用とY軸方向位置計測用のものがそれぞれ設けられているが、図1ではこれらが代表的に移動鏡17XY、ウェハ干渉計18、固定鏡29XYとして図示されている。なお、例えば、ウェハステージWSTの端面を鏡面加工して反射面(移動鏡17XYの反射面に相当)を形成しても良い。また、ウェハ干渉計18のうち、X軸方向位置計測用のレーザ干渉計及びY軸方向位置計測用のレーザ干渉計は、ともに測長軸を複数有する多軸干渉計であり、ウェハステージWSTのX、Y位置の他、回転(ヨーイング(θ_z 方向の回転)、ピッチング(θ_x 方向の回転)、ローリング(θ_y 方向の回転)も計測可能となっている。

[0042] また、図1、図2に示されるように、ウェハステージWSTの-X側の端部には45°傾いてウェハステージWSTに設置される反射鏡17Zが設置されており、ウェハ干渉計18は、この反射鏡17Zに対してもX軸に平行な測長ビームを照射している。反射鏡17Zにおいて+Z側に反射されたビームは、鏡筒定盤38の-Z側面に設置されたX軸方向に延びる固定鏡29Zによって-Z側に反射し、反射鏡17Zで再び反射されてウェハ干渉計18に戻る。ウェハ干渉計18では、この戻り光束と、上述したX軸方向位置計測用の測長ビームの戻り光束とを干渉させて、投影光学系PLの光軸AXの方向(Z軸方向)に関するウェハステージWSTの位置情報、すなわちウェハステージWSTのZ位置も、XYの検出精度と同レベルの検出精度で検出している。

[0043] 本実施形態では、投影光学系PLの直下の位置と後述するアライメント系ALGの直下の位置と、ウェハWのロード位置との間を往来する間でも、ウェハ干渉計18がウェハステージWSTのZ位置を常にモニタできるように、固定鏡29ZのX軸方向の長さが規定されている。これにより、ウェハステージWSTのXY位置に関わらず、ウェハステ

ージWSTの絶対Z位置を常に同一のウェハ干渉計18によって検出することができる。

- [0044] Z位置を含む上述したウェハステージWSTの位置情報(又は速度情報)は主制御装置20に送られている。主制御装置20は、ウェハステージWSTの位置情報(又は速度情報)に基づいて、ウェハステージ駆動部WSC(図1では不図示、図7参照)を介してウェハステージWSTのXY面内及びZ位置を含む6自由度方向の位置を制御する。
- [0045] また、露光装置100は、投影光学系PLを介した空間像を計測する空間像計測装置を備えている。図3に示されるように、ウェハステージWSTの内部には、この空間像計測装置59を構成する光学系の一部が配置されている。この空間像計測装置59は、ウェハステージWST上に設けられたステージ側構成部分、すなわちスリット板90、送光レンズ87と、ウェハステージWSTの外部に設けられたステージ外構成部分、すなわち受光レンズ89、光電変換素子から成る光センサ及び該光センサからの光電変換信号の信号処理回路52(図1、図7参照)等を含んで構成されている。
- [0046] スリット板90は、図3に示されるように、ウェハステージWSTの上面に設けられた上部が開口した突設部分58に設けられ、該突設部分58の開口を塞ぐ状態で上方から固定され、かつその上面が、ウェハホルダ70に真空吸着されたウェハWとほぼ同一面に位置するような状態で、ウェハステージWSTに固定されている。このスリット板90は、は照明光ILの透過性の良いガラス(合成石英、あるいは蛍石など)から成り、その上方には遮光膜が形成され、その遮光膜には図2に示されるようにX軸方向及びY軸方向にそれぞれ延びる所定幅の2つのスリット状の計測用パターン22X, 22Yが形成されている。以下では、この計測用パターン22X, 22Yを総称してスリット22と記述するとともに、便宜上スリット板90にスリット22が形成されているものとして説明を行う。ここで、スリット板90の表面は、非常に平坦度が高く設定され、このスリット板90は、いわゆる基準平面板をも兼ねている。
- [0047] この空間像計測装置59によるレチクルRに形成された計測マークの投影光学系PLを介しての投影像(空間像)の計測は、いわゆるスリットスキャン方式によって行われる。このスリットスキャン方式の空間像計測では、計測マークの投影光学系PLを介し

た投影像(空間像)に対してスリット板90のスリット22を走査(スキャン)し、その走査中にスリットを透過した照明光ILがウェハステージWSTの内部の光学系を経て張出部57上に設けられた送光レンズ87によりウェハステージWSTの外部に導き出される。そして、そのウェハステージWSTの外部に導き出された光は、鏡筒定盤38(図1参照)に固定されたケース92に取り付けられた送光レンズ87に比べて大径(スリットスキャン中送光レンズ87からの光を必ず入射できる程度)な受光レンズ89に入射する。この入射光はこの受光レンズ89を介してケース92内にスリット22と共役な位置に取り付けられた光電変換素子(受光素子)、例えばフォト・マルチプライヤ・チューブ(PMT)などの光センサによって受光される。該光センサからその受光量に応じた光電変換信号(光量信号)Pは増幅器、A/Dコンバータ(例えば16ビットの分解能のもの)などを含んで構成された信号処理回路52を介して主制御装置20に出力される。主制御装置20は、受光した光センサからの光電変換信号に基づいて、投影像(空間像)の光強度を検出する。

[0048] なお、上記空間像計測に際しては、先端レンズ91とウェハWとの間と同様に、先端レンズ91とスリット板90との間にも、主制御装置20からの指示に応じた液体供給装置131A及び液体回収装置131Bのコントローラの制御により、一定量の水Lq(図3参照)が保持されるようになっている。

[0049] 図3には、空間像計測装置59を用いて、レチクルRの代わりにレチクルステージRST上に保持されたレチクルR1に形成された計測マークの空間像が計測されている最中の状態が示されている。レチクルR1には、所定の箇所にY軸方向に周期性を有するL/Sパターンから成る計測マークPMが形成されているものとする。また、空間像の計測に当たり、主制御装置20により、照明系10を構成する可動レチクルブラインド12が不図示のブラインド駆動装置を介して駆動され、レチクルRの照明光ILの照明領域が計測マークPMに対応する部分のみに規定されているものとする。この状態で、照明光ILがレチクルR1に照射されると、図3に示されるように、計測マークPMによって回折、散乱した光(照明光IL)は投影光学系PLにより屈折され、投影光学系PLの像面に計測マークPMの空間像(投影像)が形成される。

[0050] この空間像が形成された状態で、主制御装置20により、ウェハステージ駆動部WS

C(図7参照)を介してウェハステージWSTがY軸方向に駆動されると、スリット22が空間像に対してY軸方向に沿って走査される。すると、この走査中にスリット22を通過する光(照明光IL)が空間像計測装置59の光センサで受光され、その光電変換信号Pが信号処理回路52を介して主制御装置20に供給される。主制御装置20では、光電変換信号Pに基づいて空間像に対応する光強度分布を計測することができる。ただし、この空間像計測の際に得られる光電変換信号(光強度信号)Pは、スリット22に依存する関数と空間像に対応する光強度分布のコンボリューションとなるため、その空間像に対応する信号を得るためには、例えば信号処理回路52等で、そのスリット22に依存する関数に関するデコンボリューションを行う必要がある。

[0051] 図1に戻り、投影ユニットPUの+X側には、オフアクシスのアライメント系ALGが、鏡筒定盤38上にフランジFLG2を介して支持されている。このアライメント系ALGとしては、例えば、ウェハW上のレジストを感光させないブロードバンドな検出光束を対象マークに照射し、その対象マークからの反射光により受光面に結像された対象マークの像と不図示の指標の像とを撮像素子(CCD)等を用いて撮像し、それらの撮像信号を出力する画像処理方式のFIA(Field Image Alignment)系のアライメントセンサが用いられている。このアライメント系ALGの撮像結果は、主制御装置20に送られる。

[0052] また、露光装置100では、そのアライメント系ALGを挟むようにして、照射系60Aと、受光系60Bとから成る多点焦点位置検出系(以下、適宜「多点AF系」と呼ぶ)が設けられている。照射系60Aは、主制御装置20によってオンオフが制御される光源を有し、アライメント系ALGの直下にウェハWがある場合、そのウェハW面に向けてスリット(又はピンホール)の像を形成するための複数の結像光束を、光軸AXに対して斜め方向より照射する。受光系60Bは、それらの結像光束のウェハW表面での反射光束を受光する。すなわち、この多点AF系は、光軸AX方向(Z軸方向)に関するウェハWの位置及びXY面に対する傾斜を検出する斜入射方式の焦点位置検出系である。本実施形態の多点AF系(60A, 60B)としては、例えば特開平6-283403号公報及びこれに対応する米国特許第5,448,332号などに開示されているものと同様の構成のものが用いられるが、本実施形態では、この多点AF系が、投影光学系PL

の近傍(さらには投影光学系の光軸を中心として)に配置されているのではなく、アライメント系ALGの近傍に設けられている。なお、本国際出願で指定した指定国(又は選択した選択国)の国内法令が許す限りにおいて、上記公報及び対応する米国特許における開示を援用して本明細書の記載の一部とする。

[0053] 照射系60A内には、例えば照明光源と、一例として8行8列のマトリクス状配列で64個のスリット状の開孔パターンが形成されたパターン板と、照射光学系などが設けられている。また、受光系60B内には、一例として8行8列のマトリクス状の配列で合計64個のスリットが形成された受光用スリット板と、該スリット板の各スリットに対向して8行8列のマトリクス状配列で配置された64個のフォトダイオード等の受光素子から成るセンサとしてのフォーカスセンサと、回転方向振動板と、受光光学系などが設けられている。

[0054] この多点AF系(60A, 60B)の各部の作用について簡単に説明すると、主制御装置20からの指示の下、照射系60A内の照明光源からの照明光によりパターン板が照明されると、例えば図4に示されるように、パターン板の各開孔パターンを透過した結像光束が照射光学系を介してウェハW表面に照射され、ウェハW表面に8行8列のマトリクス状配列で8×8、合計64個のX軸、Y軸に対して45度傾斜したスリット状の開孔パターンの像(スリット像) $S_{11} \sim S_{88}$ が形成される(図5参照)。すると、スリット像 $S_{11} \sim S_{88}$ それぞれの結像光束のウェハ表面からの反射光が受光光学系を介して受光用スリット板の各スリット上にそれぞれ再結像され、それらのスリット像の光束がフォーカスセンサによって個別に受光される。この場合、それらのスリット像の光束は、回転方向振動板により振動されているので、受光用スリット板上では再結像された各像(以下、適宜「反射スリット像」と呼ぶ)の位置が各スリットの長手方向と交差する方向に振動する。各フォーカスセンサの検出信号は図1の信号処理装置56により前記回転振動周波数の信号で同期検波される。そして、この信号処理装置56により、同期検波して得られた64点の焦点ずれ信号(デフォーカス信号)、例えばSカーブ信号が主制御装置20に供給されるようになっている。

[0055] このSカーブ信号は、受光用スリット板のスリット中心とウェハWからの反射スリット像の振動中心とが一致したときに零レベルとなり、ウェハWがその状態から上方に変位

しているときは正のレベル、ウェハWが下方に変位しているときは負のレベルになる信号である。従って、Sカーブ信号にオフセットが加えられていない状態では、主制御装置20によって、Sカーブ信号が零レベルになるウェハWの高さ位置がそれぞれ検出されることとなる。

[0056] なお、以下では、図5に示されるスリット像 $S_{11} \sim S_{88}$ が形成され、結像面からのZ位置が検出されるウェハW上の場所を、特に、計測点 $S_{11} \sim S_{88}$ と呼ぶこととする。図5に示されるように、隣接するスリット像の中心間隔は、X軸方向およびY軸方向ともに例えば10mmで規定されている。現在では、プロセスウェハの表面は、CMPプロセス等により平坦度が増しており、グローバルな面形状さえ検出することができれば良いので、この程度の間隔で十分である。また、各計測点のX軸方向及びY軸方向の長さは、例えば5mmで規定されている。この場合、全てのスリット像 $S_{11} \sim S_{88}$ がカバーする領域の面積は、 $75 \times 75 = 5625 \text{ mm}^2$ となる。したがって、この多点AF系(60A, 60B)によれば、およそ $75 \times 75 (= 5625) \text{ mm}^2$ のウェハのZ位置及び傾斜成分を一度に計測することができるようになっている。以下ではこの多点AF系(60A, 60B)の計測領域をMAと呼ぶ。

[0057] 図1に戻り、レチクルRの上方に、レチクルR上の一対のレチクルアライメントマーク(RAマーク)と基準マーク板FM上の対応する一対の第1基準マーク、例えば WM_1 , WM_2 の投影光学系PLを介した像とを同時に観察するための露光波長を用いたTT R(Through The Reticle)方式のアライメント系から成る一対のレチクルアライメント検出系(以下、便宜上「RA検出系」と呼ぶ)12A, 12Bが配置されている。これらのRA検出系12A, 12Bの検出信号は、不図示のアライメント制御装置を介して、主制御装置20に供給されるようになっている。

[0058] ここで、図1及びこの図1におけるRA検出系12Aを拡大して詳細に示す図6に基づいて、RA検出系12A, 12Bについて更に詳述する。前記一方のRA検出系12Aは、図1に示されるように、可動部33Aと、固定部32Aとの2部分を含んで構成されている。この内、可動部33Aは、図6に示されるように、プリズム28Aと、該プリズム28Aの下方に45°で斜設されたビームスプリッタ30Aと、これらを所定の位置関係で保

持するハウジングとを備えている。この可動部33Aは、X軸方向に移動自在に配置され、後述するレチクルアライメントを行う際には、主制御装置20からの指令により不図示の駆動装置により照明光ILの光路上の計測位置(図6に示される位置)に移動され、レチクルアライメントが終了すると、露光動作の邪魔にならないように、主制御装置20からの指令のもとで、不図示の駆動装置により照明光ILの光路上から退避される。

[0059] 前記プリズム28Aは、図6の計測位置にあるときに、照明光ILをレチクルR上のRAマーク(例えば RM_1)に導くためのものである。RAマークは、パターン領域PAの外側に設けられており、この部分は通常は照明する必要の無い部分であるため、本実施形態では、照明光ILの一部の光束(以下、この光束を便宜上「 IL_1 」と呼ぶ)を導くようにしたものである。プリズム28Aにより導かれた光束 IL_1 はビームスプリッタ30Aを介してRAマーク(例えば RM_1)を照明する。ビームスプリッタ30Aは、レチクルR側からの検出光束(光束 IL_1 の反射光束)を、固定部32Aに導くためのものである。

[0060] 前記固定部32Aは、結像光学系35、該結像光学系35内に配設された合焦状態調整用レンズ39を駆動する駆動装置41及び撮像素子(CCD)42等を含んで構成されている。

[0061] 前記結像光学系35としては、ここでは、内部に配設された合焦状態調整用レンズ39を駆動することにより、焦点距離を変更することができる光学系、すなわち、いわゆる内焦式の光学系が用いられている。このため、本実施形態では、主制御装置20が、例えば撮像素子42における画像信号を処理してRAマーク(例えば RM_1)や、基準マーク板FM上の第1基準マーク(例えば WM_1)の投影像に対応する光強度信号のコントラストを求め、該コントラストがピークとなるように、前述の合焦状態調整用レンズ39を駆動装置41を介して光軸方向に駆動することにより、結像光学系35の焦点をレチクルRのパターン面と撮像素子42の受光面とに合わせることができる。すなわち、結像光学系35の合焦動作を行うことができる。

[0062] 他方のRA検出系12Bは、図1及び図6に示されるように、可動部33Bと、固定部32Bとを備え、可動部33Bは、プリズム28B及びビームスプリッタ30Bを備え、上記RA検出系12Aと左右対称ではあるが、同様に構成されている(照明光 IL_2 と、レチクルR

上のRAマーク RM_2 と、第1基準マーク WM_2 との関係も同様である)。このように、RA検出系12Bの構成が他方のRA検出系12Aと同様であるので、以下、結像光学系、合焦状態調整用レンズ、駆動装置及び撮像素子の符号については、RA検出系12Aと同一の符号を用いるものとする。なお、RA検出系(12A, 12B)を用いた例えばレチクルアライメントの際にも、先端レンズ91と基準マーク板FMとの間に、主制御装置20からの指示に応じた液体供給装置131A及び液体回収装置131Bのコントローラの制御により、一定量の水 Lq (図3参照)が保持されるようになっている。

[0063] 図1に戻り、制御系は、主制御装置20を中心として構成される。主制御装置20は、CPU(中央演算処理装置)、ROM(リード・オンリ・メモリ)、RAM(ランダム・アクセス・メモリ)等の内部メモリから成るいわゆるマイクロコンピュータ(又はワークステーション)を含んで構成され、露光動作が的確に行われるように、例えばレチクルRとウェハWの同期走査、ウェハWのステッピング、露光タイミング等を統括して制御する。

[0064] 次に、本実施形態の露光装置100における一連の露光動作について詳細に説明する。上述したように、本実施形態の露光装置100においては、上記特開平6-349701号公報などに開示された露光装置とは異なり、多点AF系(60A, 60B)の計測領域MAが投影光学系PLの光軸上ではなくオフアキシスのアライメント系ALGの検出視野に対応する位置に設定されている。すなわち、本実施形態の露光装置100では、多点AF系の計測点面が光軸AX上にないため、多点AF系を用いた走査露光中にリアルタイムにウェハWの面位置を検出しつつオートフォーカス・レベリング制御を行うことができない。そこで、本実施形態の露光装置100では、ファインアライメントでのウェハアライメントマークの検出の際に、多点AF系(60A, 60B)を用いて、ウェハWの露光対象面の面形状に関する情報も検出し、走査露光中においては、この前もって検出されたウェハWの露光対象面の面形状に関する情報を用いて、走査露光中のウェハWのオートフォーカス・レベリング制御を行う。

[0065] 多点AF系(60A, 60B)により、前もって検出されたウェハWの露光対象面の面形状に関する情報を用いて、露光中のウェハWのオートフォーカス・レベリング制御を行う場合には、それらの情報を検出する検出系に関するキャリブレーションを精度良く行っておく必要がある。ここでは、このキャリブレーションにおいて検出すべき情報

について説明する。

[0066] 図8(A)には、投影光学系PLの光軸をZ軸とし、投影光学系PLの光軸AX上のベストフォーカス位置を原点とするXYZ座標系と、多点AF系(60A, 60B)の計測領域MAの中心を原点とし、X軸, Y軸, Z軸にそれぞれ平行なX'軸、Y'軸、Z'軸から成るX'Y'Z'座標系とが示されている。前提として、Z'軸は、アライメント系ALGの検出視野の中心軸BXと一致しているものとする。図8(A)に示されるように、本実施形態では、両座標系の原点は当然に一致してはいない。また、投影光学系PLの光軸AX上のベストフォーカス位置と、多点AF系(60A, 60B)の検出原点のZ位置にもずれ(ΔZ)が当然に存在する。

[0067] また、図8(B)に示されるように、投影光学系PLのベストフォーカス位置は、投影光学系PLの収差等の影響により、有効露光フィールドである露光領域(露光領域IAとする)内の各箇所では微妙に異なる。すなわち、投影光学系PLの光軸AX上のベストフォーカス位置を原点としても、露光領域IA内の他の箇所では、投影光学系PLのベストフォーカス位置が必ずしもZ=0の平面内にあるとは限らない。そこで、本実施形態では、露光領域IA内に図8(B)に示されるX軸方向に例えば3.5mm間隔で、Y軸方向に例えば4mm間隔で配置された各計測点 $P_{11} \sim P_{37}$ について空間像計測装置59などを用いてそれぞれベストフォーカス位置を計測し、複数の計測点 $P_{11} \sim P_{37}$ のベストフォーカス位置で形成される最良結像面を求める。実際の走査露光では、このベストフォーカス面にウエハWの露光対象面を焦点深度内の範囲内で一致させるように、オープンなオートフォーカス・レベリング制御を行う。

[0068] また、多点AF系(60A, 60B)においては、計測点 $S_{11} \sim S_{88}$ でのそれぞれのZ位置を複数のフォーカスセンサで独立して検出するので、各計測点のZ位置の検出原点には必ずずれが生じている。全てのフォーカスセンサのこの検出原点のずれを機械的にゼロとするのは困難である。そこで、本実施形態では、この検出原点のずれを、各計測点のオフセット成分として出力する。図8(C)には、各計測点 $S_{11} \sim S_{88}$ でのオフセット成分 $D_{11} \sim D_{88}$ の一例が模式的に示されている。このようなオフセット成分は、多点AF系(60A, 60B)で検出されたウエハWの露光対象面の面形状に関する情報の誤差となるので、実際の面形状の検出に先立って、このオフセット成分 $D_{11} \sim D_{88}$

を校正情報として検出しておく必要がある。

- [0069] すなわち、本実施形態では、露光に先立って投影光学系PLの最良結像面と、多点AF系(60A, 60B)の複数の計測点の検出原点によって形成される計測領域MAとのキャリブレーションを行う必要がある。
- [0070] 図9には、1枚のウェハに対し、露光を行う際の主制御装置20の処理アルゴリズムを示すフローチャートが示されている。図9に示されるように、まず、サブルーチン201では、投影光学系PLのベストフォーカス位置の検出を行う。すなわち、このサブルーチン201では、図10に示されるように、まず、ステップ301において、不図示のレチクルローダにより、レチクルステージRST上にレチクルR1をロードする。このレチクルR1は、図8(B)に示される露光領域IAの複数の計測点 $P_{11} \sim P_{37}$ に対応する箇所に、計測マークPM(図3参照、ここではそれぞれ計測マーク PM_{ij} ($i=1 \sim 3, j=1 \sim 7$)とする)が形成されたレチクルであるものとする。
- [0071] 次のステップ303では、レチクルR1上の中心に位置する中心マーク(図8(B)に示される計測点 P_{24} に対応する計測マーク PM_{24})が、投影光学系PLの光軸上に一致するようにレチクルステージRSTを位置決めする。次のステップ304では、液体給排システム132による水Lqの給排水を開始する。これにより、先端レンズ91とスリット板90との間には水Lqが満たされるようになる。次いで、ステップ305では、計測マークの行番号を示すカウンタiの値(以下、「カウンタ値i」とする)を1に初期化し、次のステップ307では、計測マークの列番号を示すカウンタjの値(以下、「カウンタ値j」とする)を1に初期化する。そして、ステップ307では、計測マーク PM_{ij} の部分にのみ照明光ILが照射されるように、照明系10を構成する可動レチクルブラインド12を駆動制御して照明領域を規定する。
- [0072] 次のステップ311では、スリット板90が、計測マーク PM_{ij} (ここでは、計測マーク PM_{11})の空間像をスリットスキャンが可能な走査開始位置に移動するようにウェハステージ駆動部WSCを介してウェハステージWSTを駆動する。次のステップ313では、照明光ILをレチクルR1に照射して、スリットスキャン方式により空間像計測装置59を用いて計測マーク PM_{ij} (ここでは、計測マーク PM_{11})の空間像計測を、ウェハステージWSTのZ位置を所定ステップピッチでずらしながら繰り返し行う。この各Z位置の空間

像計測の際には、ウェハ干渉計18によって計測されるウェハステージWSTのZ位置に基づいて、ウェハステージ駆動部WSCを介してウェハステージWSTのZ位置が制御されている。また、スリット板90の傾き、すなわちウェハステージWSTの投影光学系PLの光軸AXに直交するXY平面に対する傾斜は、前述のように、ウェハ干渉計18、より正確にはウェハステージWSTのピッチング、ローリングをそれぞれ検出する測長軸を有する一対のY干渉計(ピッチング干渉計として機能する)、X干渉計(ローリング干渉計として機能する)の計測値に基づいて、所望の一定角度となるように(例えばピッチング、ローリングがともに零となるように)制御されている。そして、次のステップ315では、その空間像の計測結果に基づいて得られた計測マーク PM_{ij} の空間像に関するコントラストカーブがピーク値を示すZ位置 Z_{ij} を算出し、その位置 Z_{ij} を評価点 P_{ij} におけるベストフォーカス位置として内部メモリに記憶する。

[0073] なお、ウェハステージWSTのZ位置を変更した場合には、先端レンズ91とウェハWとの間隔も変わるため、液体給排システム132により、その間に保持される水 Lq の量も適宜変更される。

[0074] 次のステップ317では、カウンタ値 j を1インクリメントする($j \leftarrow j+1$)。そして、次のステップ319では、カウンタ値 j が7を超えているか否かを判断する。ここでは、カウンタ値 j が2であるので、判断は否定され、ステップ309に戻る。

[0075] 以降、カウンタ値 j が7を越え、ステップ319において判断が肯定されるまで、ステップ309→ステップ311→ステップ313→ステップ315→ステップ317→ステップ319の処理、判断が繰り返し実行され、計測点 $P_{12} \sim P_{17}$ における計測マーク $PM_{12} \sim PM_{17}$ の空間像計測が複数のZ位置で行われ、各計測点におけるベストフォーカス位置 $Z_{11} \sim Z_{17}$ が検出され、内部メモリに格納される。

[0076] カウンタ値 j が7となり、ステップ319における判断が肯定されると、ステップ321に進む。ステップ321ではカウンタ値 i が1だけインクリメントされる($i \leftarrow i+1$)。次のステップ323では、カウンタ値 i が3を超えたか否かが判断される。ここでは、カウンタ値 $i=2$ なので、判断は否定され、ステップ307に戻る。

[0077] 以降、カウンタ値 $i=4$ となってステップ323での判断が肯定されるまで、ステップ307→ステップ309→ステップ311→ステップ313→ステップ315→ステップ317→ステ

ップ319の処理、判断が繰り返し実行され、計測点 $P_{21} \sim P_{27}$ における計測マーク $PM_{21} \sim PM_{27}$ の空間像計測が複数のZ位置で行われ、各計測点におけるベストフォーカス位置 $Z_{21} \sim Z_{27}$ が検出されて内部メモリに格納される。そして、さらにもう1回、ステップ307→ステップ309→ステップ311→ステップ313→ステップ315→ステップ317→ステップ319の処理、判断が繰り返し実行され、計測点 $P_{31} \sim P_{37}$ における計測マーク $PM_{31} \sim PM_{37}$ の空間像計測が複数のZ位置で行われ、各計測点におけるベストフォーカス位置 $Z_{31} \sim Z_{37}$ が検出され、内部メモリに格納される。

[0078] カウンタ値iが4になると、ステップ323での判断が肯定され、ステップ325に進む。ステップ325では、上述のようにして得られた各ベストフォーカス位置 Z_{11} 、 Z_{12} 、……、 Z_{37} に基づいて、所定の統計的処理を行うことにより、投影光学系PLの像面の近似平面(及び像面形状)を算出する。このとき、この像面形状とは別に像面湾曲を算出することも可能である。投影光学系PLの像面、すなわち最良結像面は、光軸からの距離が異なる無数の点(すなわち、いわゆる像の高さが異なる無数の点)におけるベストフォーカス位置の集合から成る面であるから、このような手法により、像面形状及びその近似平面を容易にかつ正確に求めることができる。

[0079] 次のステップ327では、RA検出系12A, 12Bの焦点合わせをする。まず、図6に示されるように、ウェハステージWST上の基準マーク板FMの第1基準マーク WM_1 , WM_2 が、RA検出系12A, 12Bの検出視野に入るように、ウェハステージWST上を投影光学系PLの直下に移動させる。このとき、ウェハステージWSTは、基準マーク板FMが、投影光学系PLの最良結像面に位置するようにオートフォーカス・レベリング制御されているものとする。なお、ウェハステージWSTの上面は、ウェハWを含み、ほぼ完全な平面となっているため、この移動の際には、液体給排システム132により水の給排を停止させる必要はない。

[0080] さらに、図6に示されるRA検出系12A, 12Bの可動部33A, 33Bを、不図示の駆動装置を介してレチクルR1上に移動させ、レチクルR1及び投影光学系PLを介して、ウェハステージWST上の基準マーク板FMに形成された一対の第1基準マーク WM_1 , WM_2 を照明光 IL_1 , IL_2 により照明する。これにより、それら第1基準マーク WM_1 , WM_2 部分からの反射光束が投影光学系PLを介してレチクルR1のパターン面のパタ

ーン領域PAを挟むX軸方向の両側の位置に戻り、レチクルR1のパターン面に第1基準マーク WM_1 、 WM_2 の投影像が結像される。なお、このとき、レチクルR1上のRAマークは、いずれもRA検出系12A、12Bの視野外、視野内のいずれにあっても良い。これはRAマーク、第1基準マーク WM_1 、 WM_2 ともに既知の構造であり、信号処理の過程で容易に判別可能であることによる。そして、RA検出系12A、12Bを構成するそれぞれの結像光学系35内の合焦状態調整用レンズ39を駆動装置41を介してその光軸方向に沿って所定範囲内で所定ピッチであるいは連続的に駆動する。そして、この駆動中にRA検出系(12A、12B)から出力される検出信号、すなわち第1基準マーク WM_1 、 WM_2 の像強度(光強度)信号をモニタし、そのモニタ結果に基づいてそれぞれの結像光学系35が合焦状態となる位置を見つけ、その位置に合焦状態調整用レンズ39の光軸方向位置を設定して、RA検出系12A、12Bを構成するそれぞれの結像光学系35を合焦させる。上記の合焦状態の判断は、一例として光強度信号のコントラストがピークとなる位置を見つけ、その位置を合焦位置とすることによって行うことができる。勿論、この他の手法によって、合焦状態を判断しても良い。これにより、RA検出系(12A、12B)のベストフォーカス位置は、投影光学系PLの最良結像面に一致するようになる。

[0081] 次のステップ329では、液体給排システム132により水の給排を停止される。これにより、先端レンズ91の下方の水が除去される。ステップ329が終了すると、図9のステップ203に進む。

[0082] 次のステップ203では、前述の如く基準平面板を兼ねるスリット板90がアライメント系ALGの下方(すなわち多点AF系の計測領域MA)に位置するように、ウェハステージ駆動部WSCを介してウェハステージWSTを移動させる。このとき、スリット板90の傾き、すなわちウェハステージWSTの投影光学系PLの光軸AXに直交するXY平面に対する傾斜は、ウェハ干渉計18、より正確には、ウェハステージWSTのピッチング、ローリングをそれぞれ検出する測長軸を有する一対のY干渉計(ピッチング干渉計として機能する)、X干渉計(ローリング干渉計として機能する)の計測値に基づいて、所望の一定角度となるように(例えばピッチング、ローリングがともに零となるように)制御されている。さらに、主制御装置20は、多点AF系(60A、60B)により計測さ

れる計測点 $S_{11} \sim S_{88}$ （この場合スリット板90上の各計測点）の計測結果が1つでも計測範囲からはずれ、飽和することのないような位置に、ウェハステージWSTのZ位置を調整する。

[0083] 次のステップ205では、このときの各計測点 $S_{11} \sim S_{88}$ の計測結果を取得し、この計測結果を図8(C)で示されるような計測点 $S_{11} \sim S_{88}$ のオフセット成分 $D_{11} \sim D_{88}$ として内部メモリに格納するとともに、このときのウェハステージWSTのZ位置を併せて内部メモリに格納する。

[0084] なお、ここで、ウェハステージWSTのZ位置を調整しても、計測結果が飽和する計測点がなくならない場合には、多点AF系(60A, 60B)を構成する調整部材、例えば平行平板ガラスの回転量を調整するようにしても良い。

[0085] 次のステップ207では、レチクル交換を行う。これにより、レチクルステージRSTに保持されたレチクルR1が不図示のレチクルアンローダによりアンロードされ、実際の露光に用いられるレチクルRが不図示のレチクルローダによりロードされる。

[0086] 次のステップ209では、レチクルアライメント系(12A, 12B)及び基準マーク板FM等を用いて、通常のスキャニング・ステッパと同様の手順で、レチクルアライメント及びベースライン計測などの準備作業を行う。なお、準備作業のうち、レチクルアライメントにおいては、液体給排システム132により先端レンズ91と基準マーク板FMとの間に水Lqが供給された状態で行う。レチクルアライメント後は水の給排を停止させる。

[0087] 次のステップ211では、ウェハステージWSTをローディング位置に移動させ、不図示のウェハローダによりウェハステージWST上にウェハWをロードする。次のステップ213では、サーチャライメントを行う。このサーチャライメントに関しては、例えば特開平2-272305号公報及びこれに対応する米国特許第5,151,750号などに詳細に開示されている方法と同様な方法が用いられる。本国際出願で指定した指定国（又は選択した選択国）の国内法令が許す限りにおいて、上記公報及び対応する米国特許における開示を援用して本明細書の記載の一部とする。

[0088] 次のステップ215では、ウェハステージWSTをアライメント系ALGの直下に移動させ、ウェハステージWST上のウェハWに対してウェハアライメント(ファインアライメント)を行う。ここでは、一例として、例えば特開昭61-44429号公報及びこれに対応

する米国特許第4, 780, 617号などに詳細に開示されるEGA(エンハンスド・グローバル・アライメント)方式のウエハアライメントを行うものとする。なお、本国際出願で指定した指定国(又は選択した選択国)の国内法令が許す限りにおいて、上記公報及び対応米国特許における開示を援用して本明細書の記載の一部とする。

[0089] このウエハアライメントでは、図11(A)に実線枠で示されるウエハW上の各ショット領域SAのうち、例えば図中になし地模様を付して示されるような14個のショット領域SAをサンプルショット領域として選択するものとする。ここでは、サンプルショット領域に付設されたウエハアライメントマークをアライメント系ALGにより検出して、そのマークのXY平面内の位置情報を検出し、その検出結果からウエハW上のショット領域の配列座標を後述するステップ217で算出する。

[0090] なお、このウエハアライメントでは、ウエハステージWSTをXY平面内に移動させて、各サンプルショット領域に付設されたウエハアライメントマークをアライメント系ALGの検出視野に順次移動させたうえで、そのウエハアライメントマークを検出している。言い換えれば、全サンプルショット領域に付設されたウエハアライメントマークを検出する際には、アライメント系ALGの検出視野が所定の経路で14個のサンプルショットを順次移動するようになる。図11(A)では、アライメント系ALGの検出視野が各サンプルショット領域の中心を捉えているときの多点AF系の計測領域MAが点線枠で示されている。このように、アライメント系ALGの検出視野が所定の経路で14個のサンプルショットを順次移動すると、多点AF系(60A, 60B)の計測領域MAがウエハWのほぼ全面を網羅するようになる。

[0091] そこで、ステップ215においては、アライメント系ALGによりサンプルショット領域に付設されたウエハアライメントマークを検出するとともに、多点AF系(60A, 60B)により、ウエハWの表面のZ位置(面位置)計測も合わせて行う。すなわち、アライメントALGの検出視野が各サンプルショット付近に移動する毎に、図11の点線枠で示されるような多点AF系の計測領域内の計測点 $S_{11} \sim S_{88}$ のZ位置が計測される。これにより、ほぼ全域のウエハWの露光対象面のZ位置が得られるようになる。また、この多点AF系(60A, 60B)の計測点 $S_{11} \sim S_{88}$ におけるZ位置の計測の際には、そのときのウエハステージWSTのXY平面内位置及びZ位置も、ウエハ干渉計18の計測により取得

しておく。このときのZ位置と、投影光学系PLの原点 P_{24} におけるベストフォーカス位置との差が図8(A)に示される ΔZ となる。

[0092] なお、多点AF系(60A, 60B)の計測点 $S_{11} \sim S_{88}$ の検出原点は、前述のようにずれがあるため、各計測点におけるZ位置の計測値から上記ステップ205で求めたオフセット成分 $D_{11} \sim D_{88}$ をキャンセルしておく必要がある。

[0093] このように、ステップ215におけるウエハアライメントでは、ウエハアライメントマークの計測とともに、多点AF系(60A, 60B)によりウエハWの露光対象面のZ位置が計測される。このZ位置と、そのZ位置が計測されたときのウエハ干渉計18の計測値(ウエハステージWSTのXY平面内の位置情報及びZ軸方向の位置情報)から、ウエハWの露光対象面の面形状に関する情報を取得することができる。以下では、この情報をZマップと呼び、このZマップを取得する処理をZマッピングと呼ぶものとする。なお、このZマップは、XY平面に関し離散的なデータであるので、所定の補間演算又は統計演算等により、ウエハWの露光対象面の面形状に関する情報を表す連続値関数を作成するようにしても良い。図11(B)には、図11(A)のA-A'断面におけるZマップに基づいて作成された連続値関数の一例が示されている。図中の Z_a は、このZマップにおけるウエハWの露光対象面の平均Z位置を示している。

[0094] 次のステップ217では、上記ステップ215で検出されたEGA方式のウエハアライメントの結果に基づいてウエハW上のショット領域の配列座標を計算する。そして、次のステップ219では、この配列座標と、Zマップと、上記ステップ209におけるベースライン計測結果に基づいて、走査露光中のウエハステージWSTのXYZ座標系の6自由度の位置指令プロファイルを作成する。このとき、上記ステップ215で作成されたZマップに基づいてオートフォーカス・レベリング制御に寄与する位置指令プロファイルを作成する際には、図8(A)に示されるようなZ軸とZ'軸とのずれ ΔZ を考慮する必要があることは勿論である。

[0095] 次のステップ221では、ウエハWの複数のショット領域に対する走査露光を行う。具体的には、上記ステップ219で作成したウエハステージWSTのXYZ座標系の6自由度の位置指令プロファイルに基づいて、第1番目のショット領域(ファーストショット)の露光のための加速開始位置にウエハW(ウエハステージWST)を移動させ、これと同

時に、レチクルR(レチクルステージRST)を加速開始位置へ移動させる。そして、液体給排システム132により先端レンズ91とウェハWとの間に対し水Lqの給排を開始する。そして、上記ステップ219で作成された位置指令プロファイルに基づいて、ウェハW(ウェハステージWST)とレチクルR(レチクルステージRST)とのY軸方向の相対走査(同期移動)を開始し、ウェハW上のファーストショットに対して走査露光を行う。これにより、レチクルRの回路パターンが投影光学系PLを介してウェハW上のファーストショットに対して逐次転写される。

[0096] 上記の走査露光中、ウェハWの表面上の露光領域IAが投影光学系PLの最良結像面とを実質的に一致させる(結像面の焦点深度の範囲内に収まる)ようにするために、ウェハ干渉計18で計測されるウェハステージWSTのXY平面位置及びZ位置と、ステップ215において検出されたZマップとに基づいて、ウェハステージ駆動部WSCを介してウェハステージWSTをZ軸方向、 θ_x 方向、 θ_z 方向に駆動し、ウェハWに対するオープンループのフォーカス・レベリング制御が実現される。

[0097] そして、ファーストショットに対する走査露光動作が終了すると、主制御装置20は、ウェハW上の第2番目のショット領域(セカンドショット)の露光のための加速開始位置にウェハWが位置するようにウェハステージWSTを移動させる。このとき、完全交互スキャン方式が採用されているので、レチクルステージRSTは、前ショット領域に対する走査露光のための一連の動作が終了した時点で次ショット領域に対する露光を行うための加速開始位置に移動している。

[0098] 主制御装置20は、その後レチクルステージRSTとウェハステージWSTの相対走査を開始し、前述と同様の走査露光を行い、レチクルRのパターンを投影光学系PLを介してウェハW上のセカンドショットに逐次転写し、その転写中、前述と同様のウェハWに対するオープンループのフォーカス・レベリング制御を実行する。

[0099] 以後、上記と同様のウェハステージWSTの移動(ショット間ステップ動作)及び走査露光が繰り返し行われ、ウェハW上の第3ショット領域以降のショット領域に対して、レチクルRのパターンがそれぞれ転写される。

[0100] このようにしてウェハW上の全てのショット領域に対する走査露光が終了した後、液体給排システム132による水Lqの給排が停止され、ステップ223において、ウェハス

ステージWSTをアンロード位置に移動させ、ウェハWを不図示のウェハアンローダによりアンロードする。ステップ223終了後は、処理を終了する。

- [0101] なお、本実施形態では、投影光学系PLのベストフォーカス位置を検出してから、多点AF系(60A, 60B)のオフセット成分を検出したが、これは逆であっても良い。また、サーチアライメントは行わなくても良い。また、ファインアライメントにおける、サンプルショット数は14個には限らず、例えば8個でも良い。この場合には、アライメント系A LGのアライメントマークの検出に関わらず、図11(A)に示されるような領域MAでのウェハWの面位置検出を行うようにする。
- [0102] また、ウェハWがベアウェハである場合には、ステップ213のサーチアライメント及びステップ215のファインアライメント(さらにはステップ217の配列座標計算)は行われないが、多点AF系によるウェハWの面位置検出は行う必要がある。
- [0103] これまでの説明から明らかなように、本実施形態の露光装置100では、ウェハステージWSTによってステージの少なくとも一部が構成され、ウェハ干渉計18によって、第1位置検出装置及び第2位置検出装置の少なくとも一部が構成される。また、多点AF系(60A, 60B)及び主制御装置20の一部を含んで面形状検出系が構成され、主制御装置20の一部を含んで調整装置が構成されている。また、主制御装置20の一部を含んで計測装置が構成されている。また、多点AF系(60A, 60B)を含んで焦点位置検出系が構成されている。また、RA検出系(12A, 12B)を含んで検出機構が構成されている。
- [0104] すなわち、主制御装置20のCPUが行う、ステップ215(図9)の処理によって面形状検出系の一部の機能が実現され、ステップ205、ステップ221(図9)等の処理によって調整装置の機能が実現され、サブルーチン201(図9、図10)の処理によって計測装置の機能が実現されている。また、本実施形態では、主制御装置20の機能を、1つのCPUで実現したが、複数のCPUで実現しても良い。
- [0105] 以上詳細に説明したように、本実施形態の露光装置100によれば、投影露光に先立って、ウェハステージWSTに保持されたウェハWの露光対象面の面形状に関する情報(Zマップ)を面形状検出系(多点AF系(60A, 60B), 主制御装置20の一部)により検出しておき、投影露光が行われる際には、その面形状検出系により検出され

た露光対象面の面形状に関する情報(Zマップ)などに基づいて主制御装置20によりウェハステージWST上のウェハWの面位置を調整するので、投影露光の際に、投影光学系PLの光軸AXの方向に関するウェハWの位置を、リアルタイムに検出せずとも、走査露光中のウェハW上の露光領域IAを投影光学系PLの最良結像面の焦点深度の範囲内に位置させることができ、大開口数の投影光学系の下での高精度な露光を実現することができる。

[0106] また、本実施形態では、主制御装置20は、投影光学系PLのベストフォーカス位置を計測して最良結像面を検出し、その最良結像面を基準として、ウェハWの露光対象面の面位置を調整するが、投影光学系PLの最良結像面がXY平面にほぼ平行であることが保障されていれば、投影光学系PLの最良結像面を求める必要はなく、有効露光フィールド内のいずれか1つ(例えば光軸上)の計測点におけるベストフォーカス位置を求めるだけでも良い。また、計測点 $P_{11} \sim P_{37}$ の間隔及び計測点数は、上記実施形態のものには限られない。

[0107] また、本実施形態では、投影光学系PLのベストフォーカス位置を空間像計測装置59による空間像計測により求めたが、これには限られず、ベストフォーカス位置の検出方法はどのようなものであっても良い。例えば、複数のZ位置で実際にウェハWに対する所定パターンの焼付けを行い、その焼付け結果が最も良好であったZ位置をベストフォーカス位置として決定するようにしても良い。この場合には、露光装置が空間像計測装置を備える必要はない。

[0108] また、上記実施形態では、多点AF系(60A, 60B)の計測領域MAの中心が、アライメント系ALGの検出視野の中心と一致するようにしたが、必ずしもその必要はない。アライメント系ALGによるウェハアライメントマークの検出と、多点AF系(60A, 60B)によるウェハWの面位置の検出とを同時に行わない場合には、両者を別々に配置するようにしても良い。ただし、両者を上記実施形態のように配置すれば、ウェハアライメントマークの検出と、ウェハWの面位置の検出とを同時に行えるので、スループットの的に有利である。

[0109] また、上記実施形態では、多点AF系(60A, 60B)の計測点の数は $8 \times 8 = 64$ 点であったが、これには限られないことは勿論である。また、計測領域MAの大きさや、

各計測点のサイズや向きも上記実施形態のものには限定されない。例えばこの計測点の間隔を、投影光学系PLのベストフォーカス位置の計測点の間隔(X:4mm、Y:3.5mm)と同じにしても良い。また、上記実施形態では、ウェハWの面位置を検出する検出系が多点AF系(60A, 60B)であったが、その必要はない。例えば、ウェハWの1点のみのZ位置を検出する検出系であっても良い。この場合には、その検出系のオフセット成分というものは観念できないので、上記ステップ205におけるようなオフセット成分を検出する必要はなく、図8(A)に示されるような ΔZ だけを検出すれば良い。

[0110] また、上記実施形態では、多点AF系(60A, 60B)を用いてウェハWの露光対象面の面形状に関する情報(Zマップ)を検出する際に、そのときのウェハステージWSTのZ位置をウェハ干渉計18によって計測し、その計測結果に基づいて面形状が検出されたウェハWの面を、投影光学系PLの最良結像面とに焦点深度の範囲内で一致させるようにした。このように、図1に示される露光装置100のように、投影光学系PLの下方からアライメント系ALGの下方までの広いXY平面に平行な領域を網羅するZ干渉計を備えていれば、ウェハステージWSTがどのような位置にあっても、そのZ位置は常に同一ウェハ干渉計18によって検出され、そのZ位置を絶対Z位置として用いることができる。

[0111] しかしながら、露光装置の構成は、上記実施形態のものには限られない。例えば図1に示されるようなウェハ干渉計18を備えておらず、例えば投影光学系PLの下方にあるウェハステージWSTのZ位置を計測する干渉計と、アライメント系ALGの下方にあるウェハステージWSTのZ位置を計測する干渉計とが、それぞれ独立した干渉計である露光装置やZ位置を計測する干渉計を備えていない露光装置では、アライメント位置にあるウェハWの露光対象面の面形状を検出したときのZ位置を、露光時には参照することができなくなる。

[0112] このような場合には、RA検出系(12A, 12B)を用いてZ位置の位置合わせを行うようにしても良い。以下では、その位置合わせの方法について説明する。

[0113] 例えば、上記ステップ215におけるZマッピングの際に、ウェハWの露光対象面の面形状とともに、基準マーク板FMの面位置も多点AF系(60A, 60B)を使って計測

し、内部メモリに記憶しておく。そして、ウェハステージWST上のウェハWに対し露光を行うため、ウェハステージWSTを投影光学系PLの下方に移動させた場合に、RA検出系(12A, 12B)により、基準マーク板FM上の第1基準マーク WM_1 , WM_2 を検出させる。主制御装置20は、ウェハステージWSTをZ軸方向に駆動して、RA検出系(12A, 12B)によって、第1基準マークに対応する光強度信号のコントラストがピークとなるZ位置を見つける。このとき、RA検出系(12A, 12B)では、上記ステップ327における合焦動作がすでに行われており、基準マーク板FMの表面位置が、投影光学系PLの最良結像面に合致するように設定されているものとすれば、この位置が投影光学系のベストフォーカス位置に対応していることになる。したがって、このようにすれば、基準マーク板FMの面位置とウェハWの露光対象面の面位置との相対位置関係から、現在のウェハWの露光対象面のZ位置を把握することができるので、上記実施形態と同様に、走査露光中に、ウェハWの露光対象面と投影光学系PLの最良結像面とを焦点深度の範囲内で一致させることができるようになる。

[0114] なお、上記実施形態のように、投影光学系PLの最良結像面(ベストフォーカス位置)と、RA検出系(12A, 12B)のベストフォーカス位置などを必ずしも一致させる必要はない。両者のZ軸方向のずれが既知であれば良い。RA検出系(12A, 12B)により基準マーク板FMを検出させることにより、RA検出系(12A, 12B)のベストフォーカス位置に基準マーク板FMを位置させることができれば、その時点での基準マーク板FMと投影光学系PLの最良結像面との相対位置関係がわかるので、投影光学系PLの最良結像面とウェハWの露光対象面とを焦点深度の範囲内で、一致させることは可能だからである。したがって、上記実施形態のようにRA検出系には必ずしも合焦装置が備えられている必要はない。

[0115] ただし、この場合には、投影光学系PLの最良結像面と、RA検出系のベストフォーカス位置との位置関係のキャリブレーションを予め行っておく必要がある。投影光学系PLの最良結像面については、上記実施形態と同様の方法で求めることができる。一方、RA検出系のベストフォーカス位置については、やはり基準マーク板FM上の第1基準マークの検出結果のZ軸方向に関するコントラストカーブなどから求めることができる。

- [0116] 以上述べたように、ウェハWの露光対象面の面形状を検出する際には、ウェハWの面の絶対Z位置を求めるだけでも良いが、ウェハステージWST上の基準面に対するウェハWの面の相対Z位置を求めるだけでも、投影光学系PLの最良結像面にウェハWの露光面を一致させることができる。
- [0117] なお、基準マーク板FMのZ位置の検出には、必ずしもRA検出系を用いる必要はない。要は、基準マーク板FMの表面と投影光学系PLの最良結像面との関係が求められればよく、投影光学系PLを介して基準マーク板FMの面位置を検出可能な別の検出系を用いても良いし、投影光学系PLを介さずに、例えば水なしで静電容量センサなど非光学的な検出系を用いて基準マーク板FMの面位置を検出できるようにしても良い。また、基準マーク板FMを使わずに、別途基準平面をウェハステージWST上に配置して使用するようにしても良い。
- [0118] また、上記実施形態では、特開平6-283403号公報に開示された多点AF系と同様の構成を有し、アライメント系ALGの検出視野中心と中心が一致する計測領域を有する多点AF系(60A, 60B)を用いてウェハWの露光対象面の面形状に関する情報を検出したが、これには限られない。例えば図12(A)、図12(B)に示されるような面形状検出装置を用いても良い。図12(A)に示されるように、この面形状検出装置は、ウェハステージWST上のウェハWに対し、少なくともウェハWの直径より長いライン状のビームを斜入射させる照射系75Aと、照射系75Aにより照射されたビームの反射光を受光する例えば1次元CCDセンサなどの受光系75Bを含んで構成されている。図12(B)に示されるように、この照射系75Aと受光系75Bとは、投影光学系PLとアライメント系ALGとの間に、そのライン状の照射領域SLが位置するように配置されている。
- [0119] 照射系75Aから照射されるライン状のビームは、実際には、互いに平行な複数の点状(またはスリット状)レーザ光が、一方向に並ぶことによって形成されたビームであり、この照射領域SLは、図12(C)に示されるように、実際には、複数の点状のビームの照射領域 $S_1 \sim S_n$ の集合となっている。したがって、上記実施形態の多点AF系(60A, 60B)の各計測点でのZ位置の検出原理と同じ原理で、この照射領域 $S_1 \sim S_n$ を計測点 $S_1 \sim S_n$ とし、受光系75Bにおける反射光の受光位置の基準位置からの位置

ずれ量を計測すれば、計測点 $S_1 \sim S_n$ のそれぞれのウェハWのZ位置を検出することができる。

[0120] 受光系75Bでの計測結果は、主制御装置20に送られている。主制御装置20では、この計測結果、すなわち受光系75Bにおける反射光の受光位置の基準位置からの位置ずれ量に基づいて、ウェハWの露光対象面の面形状に関する情報を検出する。

[0121] 照射領域SLを図12(B)に示されるように、計測点 $S_1 \sim S_n$ の列を、X軸およびY軸と交差するように配置したのは、例えばアライメント系ALGによるウェハアライメントマークの計測を終了した後に露光を行うため、ウェハステージWSTが、アライメント系ALGの下方(点線で示される位置)から投影光学系PLの下方(実線で示される位置)に移動する際に、ウェハステージWST上のウェハWが、この照射領域SLを通過するようになっているためである。この配置により、アライメントと露光との間にウェハステージWSTが移動する間に、この照射領域SLに対し、ウェハWが相対走査されるようになる。したがって、この相対走査の間(ウェハWが、照射領域SLを通過している間)、計測点 $S_1 \sim S_n$ の計測結果を所定のサンプリング間隔で検出していけば、その検出結果がウェハWの露光対象面全体の面形状を検出することができる。このように、アライメント位置(アライメント系ALGでウェハW上のアライメントマークの検出が行われる計測位置)から露光位置(投影光学系PLを使ってウェハ(基板)Wの露光が行われる露光位置)までウェハステージWSTを移動させる間にウェハWの面形状を検出すれば、スループットを低下させることなく、ウェハWの露光対象面の面形状を検出することができるようになる。もちろん、アライメント位置から露光位置へのウェハステージWSTを移動させる間に限らず、例えば次に露光されるウェハWをウェハステージWST上に搭載するウェハローディング位置から上記アライメント位置へウェハステージWSTを移動する間に、すなわちアライメント系ALGによるウェハW上のアライメントマークの検出を行う前に、ウェハWの露光対象面の面形状を検出するようにしても良い。

[0122] なお、計測点 $S_1 \sim S_n$ の列の配置は、上述の例に限られず、X軸またはY軸と平行に配置しても良い。また、計測点 $S_1 \sim S_n$ を用いたウェハWの面形状の計測は、ウェハアライメントマークの計測動作とウェハ露光動作との間に限らず、例えばウェハアライメ

ントマークの計測前に行うようにしても良い。要は、ウェハWの露光前に、照射領域SLに対してウェハWが相対走査されれば良い。

[0123] また、図13に示されるような構成を有する面形状検出装置を備えるようにしても良い。図13に示される面形状検出装置は、斜入射する照明光を出射する不図示の光源と、該光源とウェハステージWST上のウェハWとの間に挿入された半透明参照面を有する平行平板96と、受光装置95とを含んで構成されている。光源から照射され平行平板96に入射する照明光の光束の大きさは、少なくともウェハWの面積よりも十分に大きくなるように設定されている。図13に示されるように、実線で示される入射光の一部は、平行平板96を通過してウェハWの露光対象面に至り、その面で反射され、平行平板96に再度入射する。再度入射した反射光は、その入射位置の半透明参照面で反射した点線で示される入射光と重なり、2次元CCDカメラ等の受光装置95においてそれらの干渉縞が形成されるようになる。したがって、その干渉縞の検出結果から、ウェハWの露光対象面の面形状を検出することができる。通常のフィゾー干渉計においては、被検反射物体に対する入射光波の入射角を垂直に規定しているが、図13に示されるような干渉計による面形状検出装置にあつては、入射光波がウェハWの露光対象面に対し斜入射するように設定されている。このようにすれば、ウェハW上に形成された回路パターン等の影響を軽減することができるとともに、縞感度を向上させることもできるようになる。

[0124] もっとも、ウェハWの露光対象面の面形状を測定するための干渉計の構成は図13に示されるようなものには限られない。上述のような入射光波が被検面に対して垂直に入射するフィゾー干渉計やトワイマン－グリーン干渉計のようなものであっても良い。また、特開平4－221704号公報や特開2001－4336号公報に開示されるような斜入射干渉計であっても良い。

[0125] なお、図13に示されるような面形状検出装置の配置は自由であり、例えば、ウェハのローディング位置近傍であっても良いし、図12(B)に示される面形状検出装置と同じような配置であっても良い。

[0126] また、上記実施形態では、ウェハステージWSTに設けられたZ位置計測用の移動鏡は、－X端に設けられた移動鏡17Zのみであつたが、これに限らず、移動鏡17Zの

ような移動鏡をウェハステージWSTの+X端にも設け、+X側からも測長ビームを当て、両側のZ位置の計測結果(例えばそれらの平均)から、ウェハステージWSTのZ位置を求めるようにしても良い。このようにすれば、ウェハステージWSTのローリングによらず、ウェハステージWSTのZ位置を精度良く計測することが可能となる。

[0127] また、Z軸方向に関する移動鏡としては、図1等にも示されるような移動鏡17Zのような移動鏡には限られず、例えば、X軸に平行な測長ビームが必ずZ軸に平行なビームとなるように反射させるプリズムをZ位置計測用の移動鏡として用いるようにしても良い。

[0128] また、上記実施形態では、ウェハステージWSTのXY平面内の位置及びZ位置を計測可能なウェハ干渉計18を用いたが、XY平面内の位置を計測可能な干渉計と、Z位置を計測可能な干渉計を別々に備えるようにしても良いことは勿論である。

[0129] また、Z位置計測用の移動鏡は、ウェハステージWSTの側面に設けられている必要はなく、XY位置計測用の移動鏡と一体となっても良い。また、ウェハステージWSTの底面に移動鏡を設け、ウェハステージWSTの-Z側から測長ビームを当て、ウェハステージWSTのZ位置を計測するようにしても良い。

[0130] なお、上記実施形態では、液体として超純水(水)を用いるものとしたが、本発明がこれに限定されないことは勿論である。液体としては、化学的に安定で、照明光ILの透過率が高く安全な液体、例えばフッ素系不活性液体を使用しても良い。このフッ素系不活性液体としては、例えばフロリナート(米国スリーエム社の商品名)が使用できる。このフッ素系不活性液体は冷却効果の点でも優れている。また、液体として、照明光ILに対する透過性があるだけ屈折率が高く、また、投影光学系やウェハ表面に塗布されているフォトレジストに対して安定なもの(例えばセダー油等)を使用することもできる。また、 F_2 レーザを光源とする場合は、フロンブリンオイルを選択すれば良い。

[0131] また、上記実施形態で、回収された液体を再利用するようにしても良く、この場合は回収された液体から不純物を除去するフィルタを液体回収装置、又は回収管等に設けておくことが望ましい。

[0132] なお、上記実施形態では、投影光学系PLの最も像面側の光学素子が先端レンズ

91であるものとしたが、その光学素子は、レンズに限られるものではなく、投影光学系PLの光学特性、例えば収差(球面収差、コマ収差等)の調整に用いる光学プレート(平行平板等)であっても良いし、単なるカバーガラスであっても良い。投影光学系PLの最も像面側の光学素子(上記実施形態では先端レンズ91)は、照明光ILの照射によってレジストから発生する飛散粒子又は液体中の不純物の付着等に起因して液体(上記実施形態では水)に接触してその表面が汚れることがある。このため、その光学素子は、鏡筒40の最下部に着脱(交換)自在に固定することとし、定期的に交換することとしても良い。

[0133] このような場合、液体に接触する光学素子がレンズであると、その交換部品のコストが高く、かつ交換に要する時間が長くなってしまい、メンテナンスコスト(ランニングコスト)の上昇やスループットの低下を招く。そこで、液体と接触する光学素子を、例えば先端レンズ91よりも安価な平行平板とするようにしても良い。

[0134] また、上記実施形態において、液体(水)を流す範囲はレチクルのパターン像の投影領域(照明光ILの照射領域)の全域を覆うように設定されていれば良く、その大きさは任意で良いが、流速、流量等を制御する上で、照射領域よりも少し大きくしてその範囲をできる限り小さくしておくことが望ましい。

[0135] なお、複数のレンズから構成される投影光学系、投影ユニットPUを露光装置本体に組み込み、更に、投影ユニットPUに液体給排ユニット132を取り付ける。その後、光学調整をするとともに、多数の機械部品からなるレチクルステージやウエハステージを露光装置本体に取り付けて配線や配管を接続し、更に総合調整(電気調整、動作確認等)をすることにより、上記実施形態の露光装置を製造することができる。なお、露光装置の製造は温度及びクリーン度等が管理されたクリーンルームで行うことが望ましい。

[0136] また、上記実施形態では、ステップ・アンド・スキャン方式等の走査型露光装置に本発明が適用された場合について説明したが、本発明の適用範囲がこれに限定されないことは勿論である。すなわちステップ・アンド・リピート方式の縮小投影露光装置にも本発明は好適に適用できる。また、ショット領域とショット領域とを合成するステップ・アンド・スティッチ方式の縮小投影露光装置における露光にも本発明を好適に適用

することができる。また、ウェハステージを2基備えたツインステージ型の露光装置にも適用できる。また、液浸法を用いない露光装置にも本発明を適用することができるのは勿論である。

- [0137] 露光装置の用途としては半導体製造用の露光装置に限定されることなく、例えば、角型のガラスプレートに液晶表示素子パターンを転写する液晶用の露光装置や、有機EL、薄膜磁気ヘッド、撮像素子(CCD等)、マイクロマシン及びDNAチップなどを製造するための露光装置にも広く適用できる。また、半導体素子などのマイクロデバイスだけでなく、光露光装置、EUV露光装置、X線露光装置、及び電子線露光装置などで使用されるレチクル又はマスクを製造するために、ガラス基板又はシリコンウェハなどに回路パターンを転写する露光装置にも本発明を適用できる。
- [0138] また、上記実施形態の露光装置の光源は、ArFエキシマレーザ光源に限らず、KrFエキシマレーザ光源、F₂レーザ光源などのパルスレーザ光源や、g線(波長436nm)、i線(波長365nm)などの輝線を発する超高圧水銀ランプなどを用いることも可能である。また、DFB半導体レーザ又はファイバーレーザから発振される赤外域、又は可視域の単一波長レーザ光を、例えばエルビウム(又はエルビウムとイッテルビウムの両方)がドーピングされたファイバーアンプで増幅し、非線形光学結晶を用いて紫外光に波長変換した高調波を用いても良い。また、投影光学系の倍率は縮小系のみならず等倍および拡大系のいずれでも良い。
- [0139] また、上記実施形態では、露光装置の照明光ILとしては波長100nm以上の光に限らず、波長100nm未満の光を用いても良いことはいうまでもない。例えば、近年、70nm以下のパターンを露光するために、SORやプラズマレーザを光源として、軟X線領域(例えば5～15nmの波長域)のEUV(Extreme Ultraviolet)光を発生させるとともに、その露光波長(例えば13.5nm)の下で設計されたオール反射縮小光学系、及び反射型マスクを用いたEUV露光装置の開発が行われている。この装置においては、円弧照明を用いてマスクとウェハを同期走査してスキャン露光する構成が考えられる。
- [0140] また、電子線又はイオンビームなどの荷電粒子線を用いる露光装置にも、本発明は適用できる。なお、電子線露光装置は、ペンシルビーム方式、可変成形ビーム方式、

セルプロジェクション方式、ブランキング・アパーチャ・アレイ方式、及びマスク投影方式のいずれであっても良い。例えば、電子線を用いる露光装置では、電磁レンズを備えた光学系が用いられるが、この光学系が露光光学系を構成し、この露光光学系の鏡筒などを含ん露光光学系ユニットが構成される。

[0141] 《デバイス製造方法》

次に、上述した露光装置100をリソグラフィ工程で使用したデバイスの製造方法の実施形態について説明する。

[0142] 図14には、デバイス(ICやLSI等の半導体チップ、液晶パネル、CCD、薄膜磁気ヘッド、マイクロマシン等)の製造例のフローチャートが示されている。図14に示されるように、まず、ステップ801(設計ステップ)において、デバイスの機能・性能設計(例えば、半導体デバイスの回路設計等)を行い、その機能を実現するためのパターン設計を行う。引き続き、ステップ802(マスク製作ステップ)において、設計した回路パターンを形成したマスクを製作する。一方、ステップ803(ウエハ製造ステップ)において、シリコン等の材料を用いてウエハを製造する。

[0143] 次に、ステップ804(ウエハ処理ステップ)において、ステップ801～ステップ803で用意したマスクとウエハを使用して、後述するように、リソグラフィ技術等によってウエハ上に実際の回路等を形成する。次いで、ステップ805(デバイス組立てステップ)において、ステップ804で処理されたウエハを用いてデバイス組立てを行う。このステップ805には、ダイシング工程、ボンディング工程、及びパッケージング工程(チップ封入)等の工程が必要に応じて含まれる。

[0144] 最後に、ステップ806(検査ステップ)において、ステップ805で作成されたデバイスの動作確認テスト、耐久テスト等の検査を行う。こうした工程を経た後にデバイスが完成し、これが出荷される。

[0145] 図15には、半導体デバイスにおける、上記ステップ804の詳細なフロー例が示されている。図15において、ステップ811(酸化ステップ)においてはウエハの表面を酸化させる。ステップ812(CVDステップ)においてはウエハ表面に絶縁膜を形成する。ステップ813(電極形成ステップ)においてはウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップ814(イオン打ち込みステップ)においてはウエハにイオンを打ち込む。

。以上のステップ811～ステップ814それぞれは、ウエハ処理の各段階の前処理工程を構成しており、各段階において必要な処理に応じて選択されて実行される。

[0146] ウエハプロセスの各段階において、上述の前処理工程が終了すると、以下のようにして後処理工程が実行される。この後処理工程では、まず、ステップ815(レジスト形成ステップ)において、上記実施形態に示されるように、ウエハに感光剤を塗布する。引き続き、ステップ816(露光ステップ)において、上記実施形態の露光装置100を用いてマスクの回路パターンをウエハに転写する。次に、ステップ817(現像ステップ)においては、露光されたウエハを現像し、ステップ818(エッチングステップ)において、レジストが残存している部分以外の部分の露出部材をエッチングにより取り去る。そして、ステップ819(レジスト除去ステップ)において、エッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。

[0147] これらの前処理工程と後処理工程とを繰り返し行うことによって、ウエハ上に階層的に回路パターンが形成される。

[0148] 以上説明した本実施形態のデバイス製造方法を用いれば、露光工程(ステップ816)において上記実施形態の露光装置100及び露光方法が用いられるので、高精度な露光を実現することができる。この結果、高集積度のデバイスの生産性(歩留まりを含む)を向上させることが可能になる。

産業上の利用可能性

[0149] 以上説明したように、本発明の露光装置及び露光方法は、半導体素子、液晶表示素子等を製造するためのリソグラフィ工程に適しており、本発明のデバイス製造方法は、マイクロデバイスの生産に適している。また、本発明の面形状検出装置は、被露光基板の面形状の検出に適している。

請求の範囲

- [1] 投影光学系を介して物体を露光する露光装置であって、
前記投影光学系の光軸方向及びその光軸に直交する平面内の2次元方向を含む少なくとも3自由度方向に、前記物体を保持して移動可能で、前記物体の前記光軸方向に関する位置を調整可能なステージと；
前記光軸方向に関する前記ステージの位置情報を検出する第1位置検出装置と；
前記光軸に直交する平面内における前記ステージの位置情報を検出する第2位置検出装置と；
前記露光に先立って、前記ステージに保持された前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出する面形状検出系と；
前記物体に対する露光を行う際に、前記面形状検出系の検出結果と前記第1及び第2位置検出装置の検出結果とに基づいて前記ステージを駆動することにより、前記物体の露光対象面の面位置を調整する調整装置と；を備える露光装置。
- [2] 請求項1に記載の露光装置において、
前記投影光学系のベストフォーカス位置を計測する計測装置をさらに備え、
前記調整装置は、前記計測装置の計測結果を基準として、前記物体の露光対象面の面位置を調整することを特徴とする露光装置。
- [3] 請求項2に記載の露光装置において、
前記計測装置は、前記ステージに設けられ前記投影光学系の光軸に直交する平面内に配置された所定の計測用パターンを介して前記投影光学系によって形成される空間像を計測する空間像計測器を有し、該空間像計測器を用いて、有効露光フィールド内の少なくとも1箇所での前記光軸方向に関する前記ステージの位置の変化に対する前記空間像の変化を計測し、その計測結果に基づいて前記投影光学系のベストフォーカス位置を計測することを特徴とする露光装置。
- [4] 請求項1に記載の露光装置において、
前記物体上に形成されたアライメントマークを検出するためのオフアクシスのアライメント系をさらに備え、
前記面形状検出系は、前記アライメント系により前記アライメントマークが検出される

際に、前記物体の露光対象面の前記光軸方向に関する位置を検出する焦点位置検出系を有し、該焦点位置検出系の検出結果と、前記焦点位置検出系により前記露光対象面の前記光軸方向に関する位置が検出される際の前記第2位置検出装置の検出結果とに基づいて、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出することを特徴とする露光装置。

[5] 請求項4に記載の露光装置において、

前記焦点位置検出系は、前記物体上の複数の計測点に計測光を照射し、その反射光を検出することによって前記各計測点における前記光軸方向に関する前記物体の露光対象面の位置をそれぞれ検出可能な多点焦点位置検出系であることを特徴とする露光装置。

[6] 請求項5に記載の露光装置において、

前記面形状検出系は、前記計測点間の検出原点ずれを検出し、その検出結果を考慮して、前記物体の露光対象面の面形状を検出することを特徴とする露光装置。

[7] 請求項1に記載の露光装置において、

前記面形状検出系は、前記ステージの移動によりそのステージに保持された前記物体が横切る帯状の領域に照明光を照射する照射系と、前記帯状の領域を前記物体が横切る際のその物体の露光対象面からの前記照明光の反射光を受光する受光系とを含み、前記受光系における反射光の受光位置の基準位置からの位置ずれ量に基づいて、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出することを特徴とする露光装置。

[8] 請求項1に記載の露光装置において、

前記面形状検出系は、干渉計を有し、該干渉計を用いて、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出することを特徴とする露光装置。

[9] 請求項8に記載の露光装置において、

前記干渉計は、その光波が前記物体の露光対象面に対し斜入射する斜入射干渉計であることを特徴とする露光装置。

[10] 請求項1に記載の露光装置において、

前記調整装置は、前記面形状検出系により前記物体の露光対象面の面形状に関

する情報が検出される際に、前記第1位置検出装置によって検出された前記光軸方向に関する前記ステージの位置情報を考慮して、前記物体に対する露光を行う際に、前記物体の露光対象面の面位置を調整することを特徴とする露光装置。

[11] 請求項1に記載の露光装置において、

前記面形状検出系は、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報とともに、その露光対象面と前記ステージの基準面との前記光軸方向に関する相対位置に関する情報を検出することを特徴とする露光装置。

[12] 請求項11に記載の露光装置において、

前記投影光学系を介して前記光軸方向に関する前記ステージの位置を検出可能な検出機構をさらに備え、

前記調整装置は、前記露光に先立って、前記検出機構の検出結果と、前記相対位置に関する情報と、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報とに基づいて、前記光軸方向に関する前記物体の露光対象面の面位置を特定することを特徴とする露光装置。

[13] 請求項12に記載の露光装置において、

前記調整装置は、前記検出機構の検出基準と前記投影光学系のベストフォーカス位置との差を検出し、その検出結果を考慮して、前記物体の露光対象面の面位置を調整することを特徴とする露光装置。

[14] 請求項1に記載の露光装置において、

前記物体の露光対象面の面位置に関する情報の検出を、前記面形状検出系と前記物体との間に液体を満たさない状態で行い、

前記露光を、前記投影光学系と前記物体との間に液体を満たした状態で行うことを特徴とする露光装置。

[15] 請求項1～14のいずれか一項に記載の露光装置を用いて、物体上にデバイスパターンを転写するリソグラフィ工程を含むデバイス製造方法。

[16] 投影光学系を介して物体を露光する露光方法であって、

露光に先立って、前記投影光学系の光軸方向に関する前記物体の露光対象面の面形状に関する情報とともに前記光軸方向に関する前記物体の基準位置に関する

情報を検出する検出工程と;

前記検出結果に基づいて、前記物体の露光対象面の面位置を調整しつつ露光を行う露光工程と;を含む露光方法。

- [17] 請求項16に記載の露光方法において、
前記露光工程に先立って、
前記投影光学系のベストフォーカス位置を計測するベストフォーカス計測工程をさらに含み、
前記露光工程では、
前記投影光学系のベストフォーカス位置を基準として、前記物体の露光対象面の面位置を調整することを特徴とする露光方法。
- [18] 請求項16に記載の露光方法において、
前記検出工程に先立って、
前記投影光学系の光軸方向に関する前記物体の露光対象面の面形状に関する情報とともに前記光軸方向に関する前記物体の基準位置に関する情報を検出する検出系の校正を行う校正工程をさらに含む露光方法。
- [19] 請求項16に記載の露光方法において、
前記検出工程を、前記物体上に形成されたアライメントマークの検出中に行うことを特徴とする露光方法。
- [20] 請求項16に記載の露光方法において、
前記検出工程では、
前記光軸方向に関する前記物体の基準位置に関する情報として、前記露光対象面の面形状に関する情報が検出される際の前記物体を保持するステージの前記光軸方向に関する位置情報を検出することを特徴とする露光方法。
- [21] 請求項16に記載の露光方法において、
前記検出工程では、
前記光軸方向に関する前記物体の基準位置に関する情報として、前記物体を保持するステージの基準面と前記露光対象面との前記光軸方向に関する相対位置に関する情報を検出することを特徴とする露光方法。

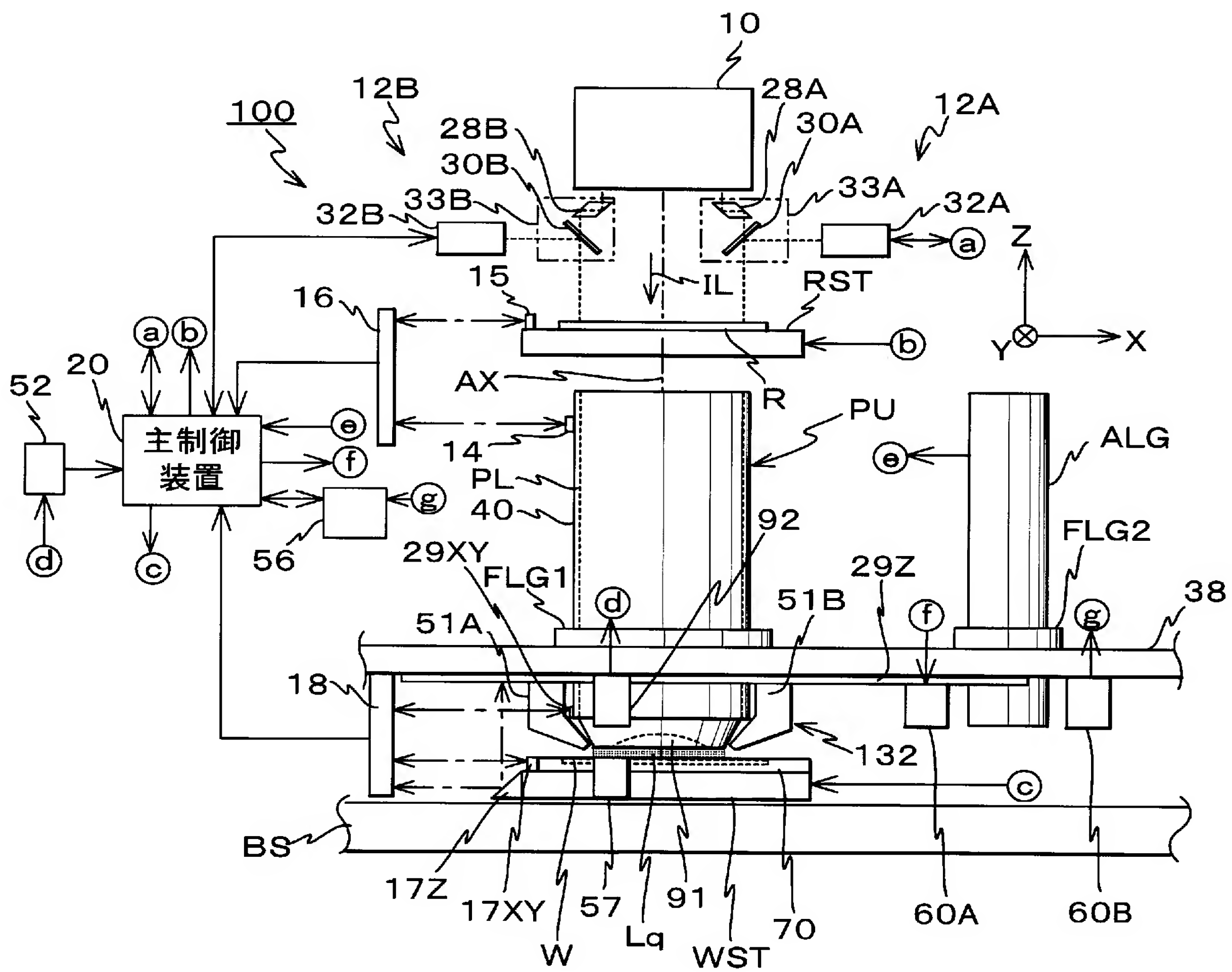
- [22] 請求項21に記載の露光方法において、
前記露光工程に先立って、
前記投影光学系を介して、前記ステージの基準面の前記光軸方向に関する位置を検出する基準面位置検出工程をさらに含み、
前記露光工程では、
前記基準面位置検出工程の検出結果と、前記相対位置に関する情報と、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報とに基づいて、前記光軸方向に関する前記物体の露光対象面の面位置を特定することを特徴とする露光方法。
- [23] 請求項22に記載の露光方法において、
前記基準面位置検出工程に先立って、
前記物体の露光対象面の面位置の基準位置と、前記投影光学系のベストフォーカス位置とを較正情報として検出する較正情報検出工程をさらに含み、
前記露光工程では、前記較正情報を考慮して、前記物体の露光対象面の面位置を調整することを特徴とする露光方法。
- [24] 請求項16に記載の露光方法において、
前記露光工程では、前記投影光学系と前記物体との間に液体を満たした状態で前記物体に対する露光を行うことを特徴とする露光方法。
- [25] 請求項16～24のいずれか一項に記載の露光方法を用いて、物体上にデバイスパターンを転写するリソグラフィ工程を含むデバイス製造方法。
- [26] 物体を保持可能で、所定の方法に移動可能なステージと；
前記ステージの移動によりそのステージに保持された前記物体が横切る帯状の領域に照明光を照射する照射系と；
前記帯状の領域を前記物体が横切る際のその物体の露光対象面からの前記照明光の反射光を受光する受光系と；
前記受光系における反射光の受光位置の基準位置からの位置ずれ量に基づいて、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出する検出装置と；を備える面形状検出装置。
- [27] 露光対象の物体を保持可能で、所定の方法に移動可能なステージと；

前記ステージの移動によりそのステージに保持された前記物体が横切る帯状の領域に照明光を照射する照射系と、前記帯状の領域を前記物体が横切る際のその物体の露光対象面からの前記照明光の反射光を受光する受光系とを有し、前記受光系の出力に基づいて、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出する検出装置と；

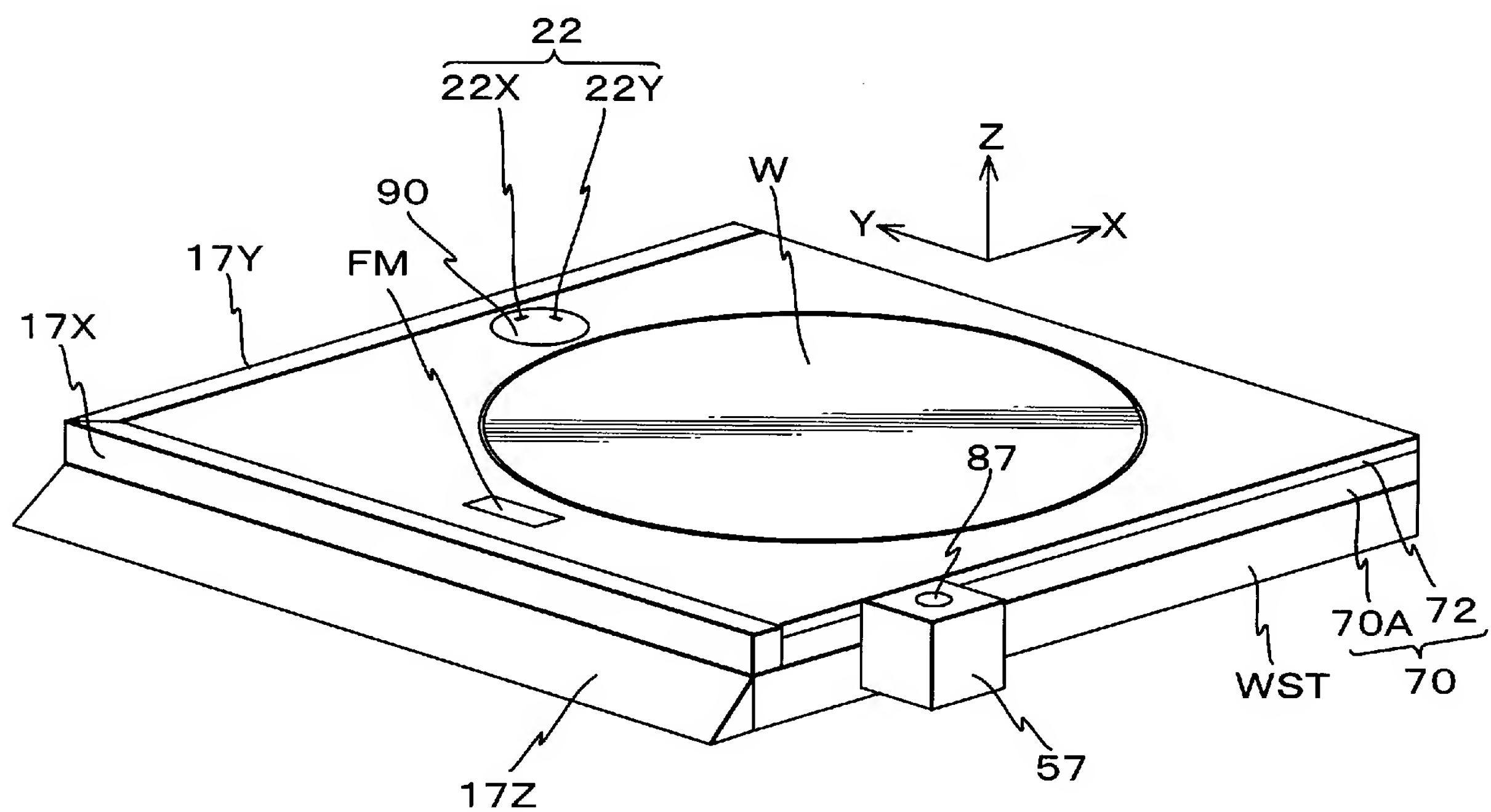
前記帯状領域を前記物体が横切るように前記ステージを制御するとともに、前記帯状領域を前記物体が一度横切ることによって得られる、前記物体の露光対象面のほぼ全域の面形状の情報に基づいて、前記物体の露光対象面の面位置調整を行う制御装置と；を備える露光装置。

- [28] 請求項27に記載の露光装置において、
前記物体上に露光光を照射するための光学系と；
前記物体と前記光学系との間の空間を液体で満たす液浸機構とをさらに備え、
前記検出装置は、前記液浸機構により前記物体と前記光学系との間の空間を液体で満たす前に、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出することを特徴とする露光装置。
- [29] 請求項28に記載の露光装置において、
前記物体上のアライメントマークを検出するアライメント系をさらに備え、
前記アライメント系は、前記液浸機構により前記物体と前記光学系との間の空間を液体で満たす前に、前記物体上のアライメントマークを検出することを特徴とする請求項28に記載の露光装置。
- [30] 請求項29に記載の露光装置において、
前記検出装置は、前記アライメント系による前記アライメントマークの検出後に、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出することを特徴とする露光装置。
- [31] 請求項29に記載の露光装置において、
前記検出装置は、前記アライメント系による前記アライメントマークの検出前に、前記物体の露光対象面の面形状に関する情報を検出することを特徴とする露光装置。
- [32] 請求項27～31のいずれか一項に記載の露光装置を用いて、物体上にデバイスパターンを形成するリソグラフィ工程を含むデバイス製造方法。

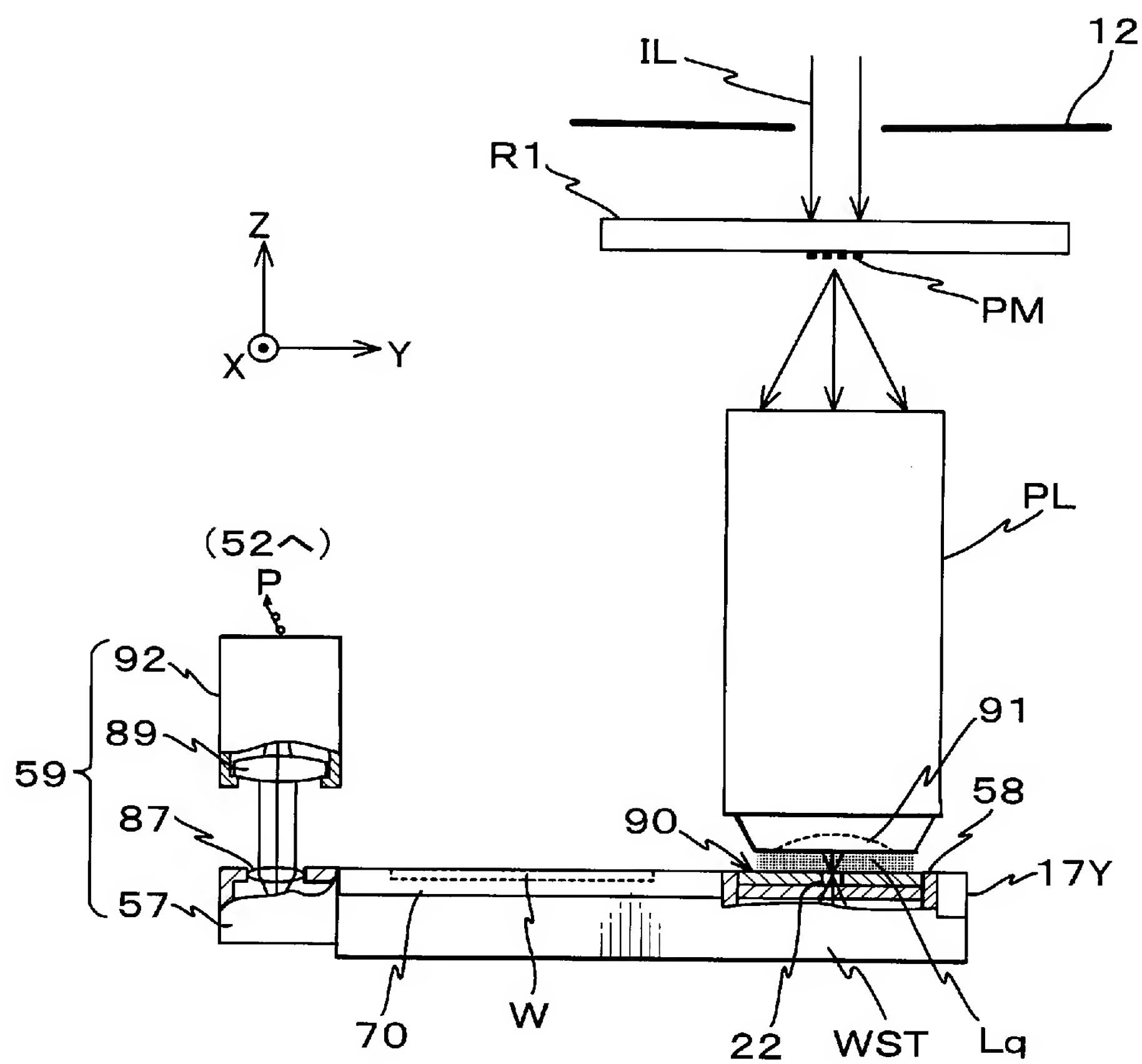
[図1]



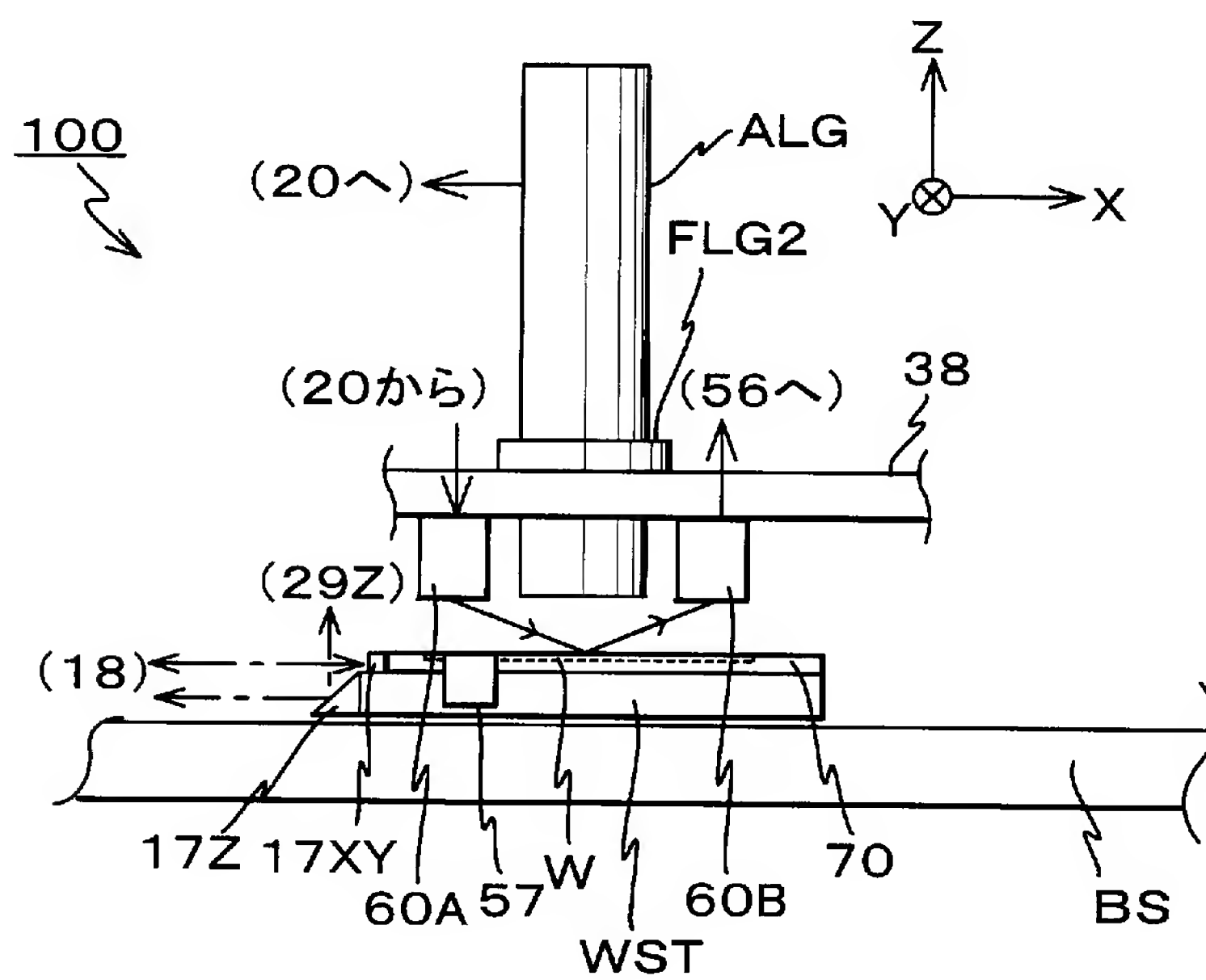
[図2]



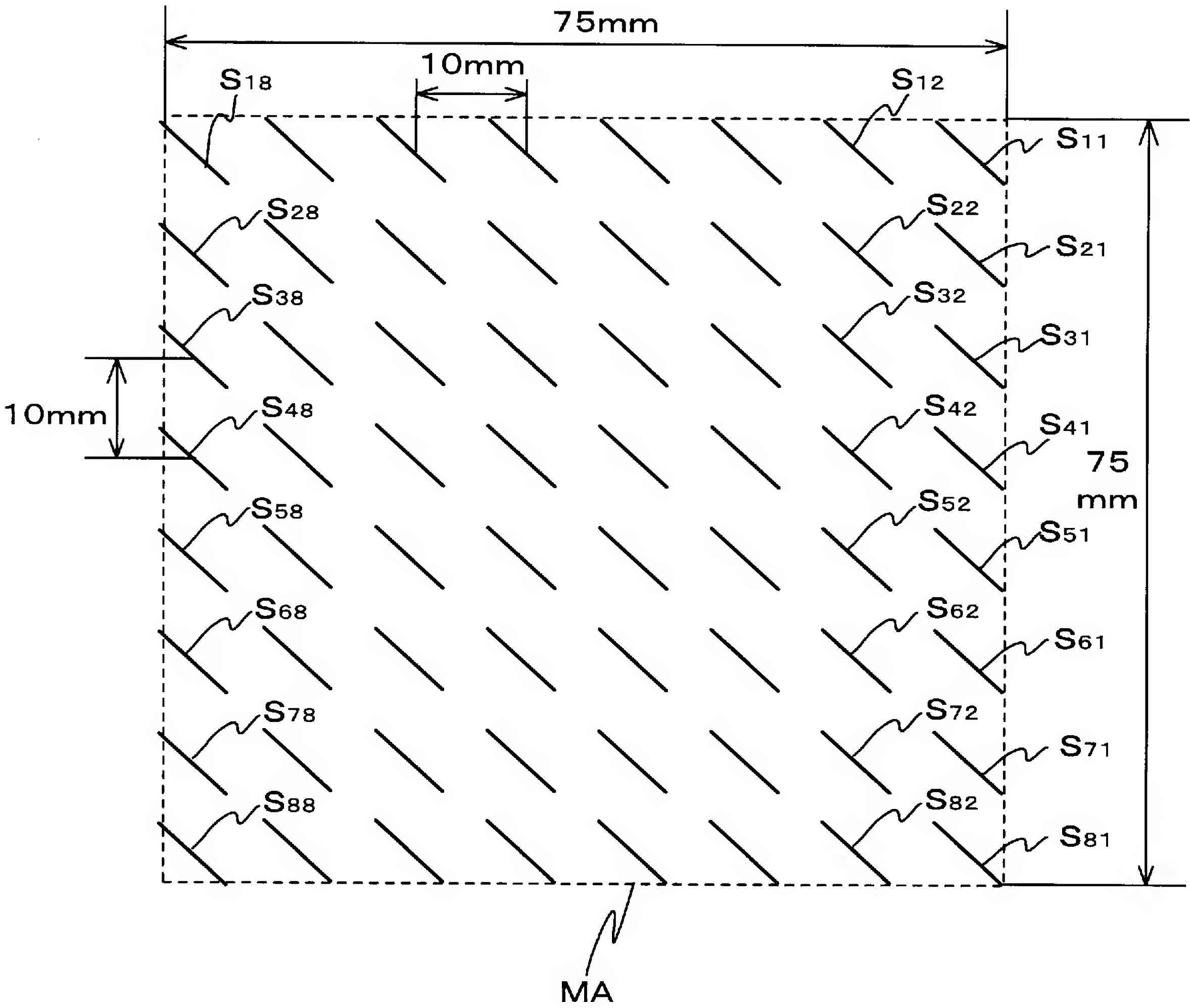
[図3]



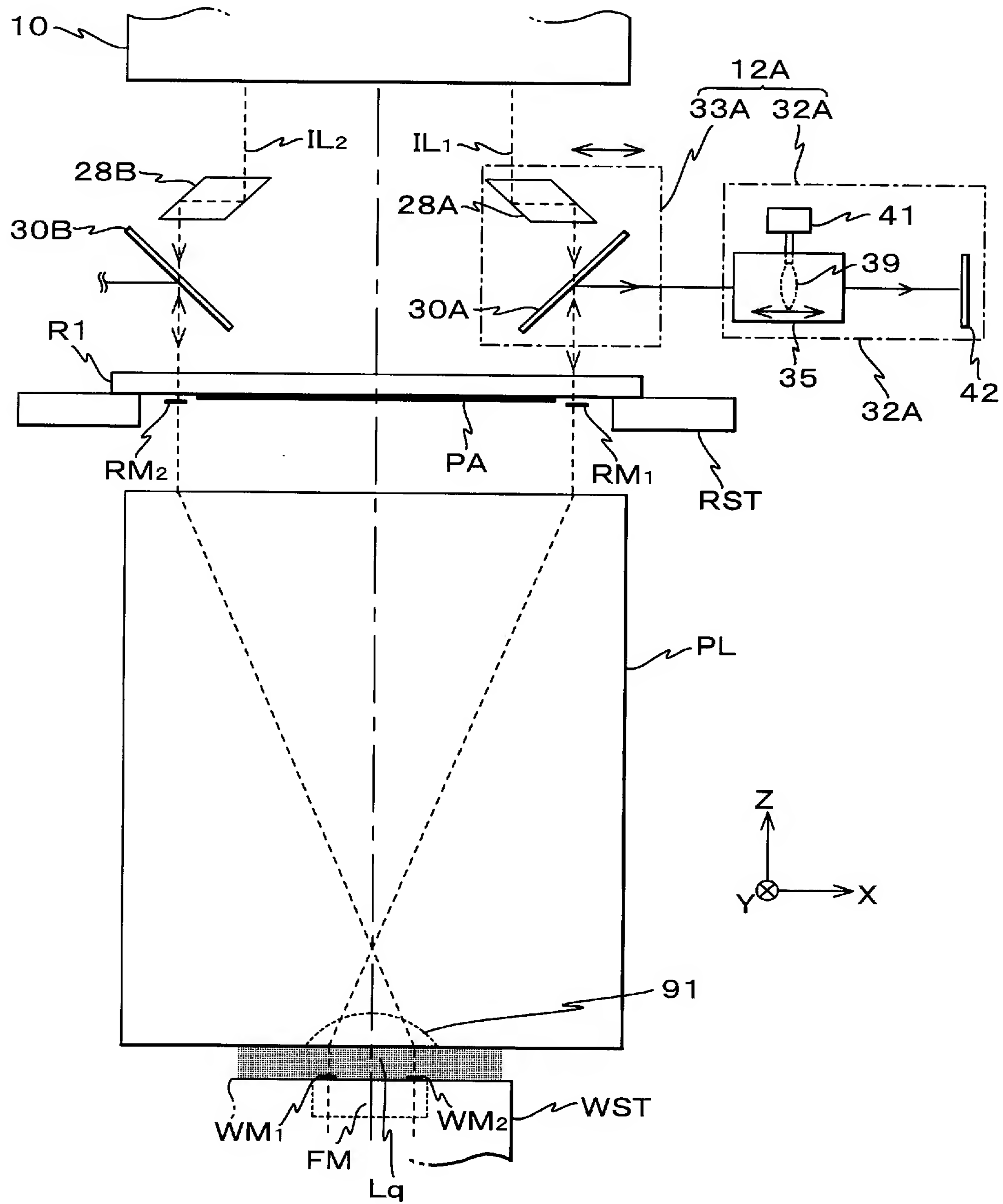
[図4]



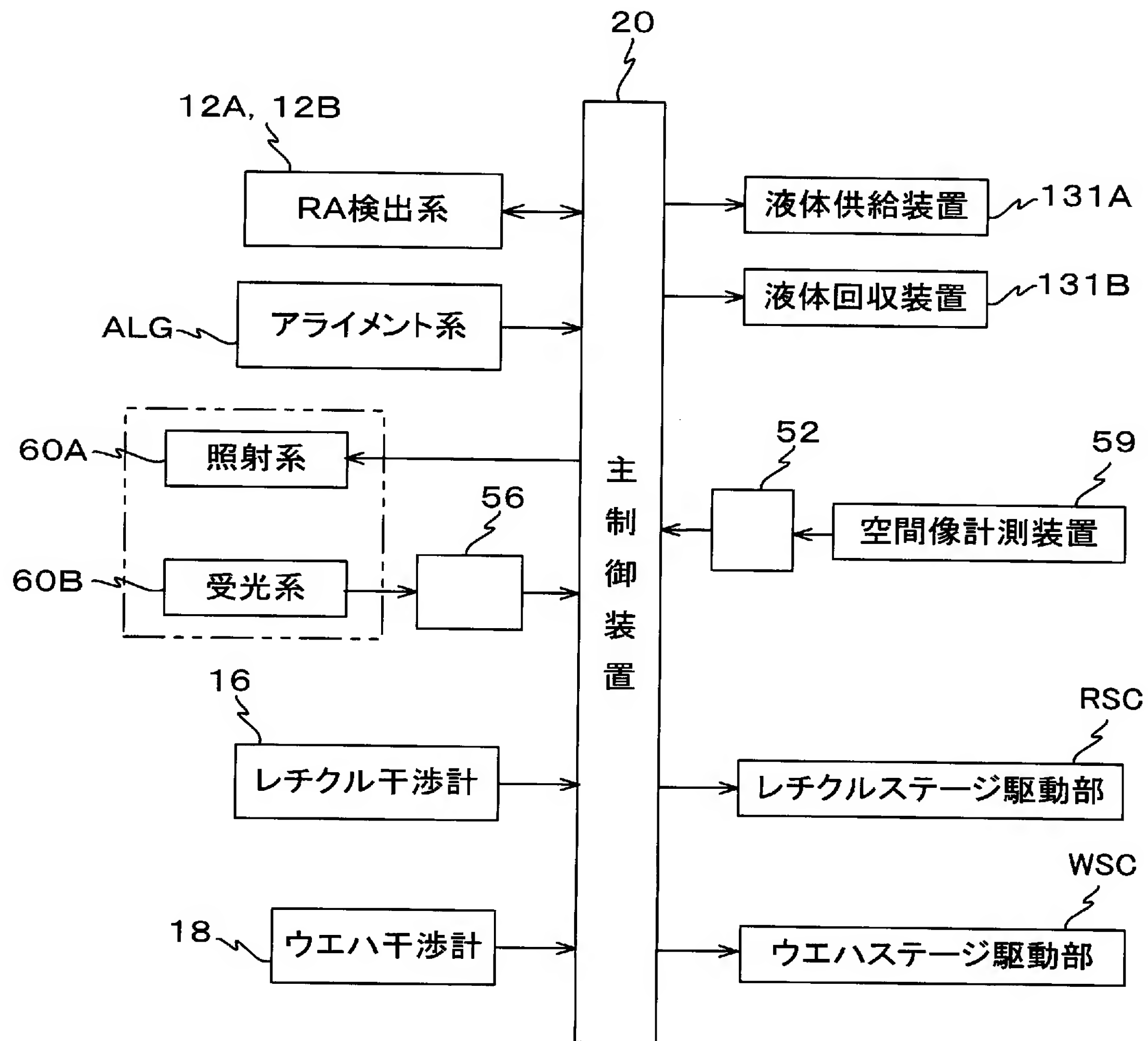
[図5]



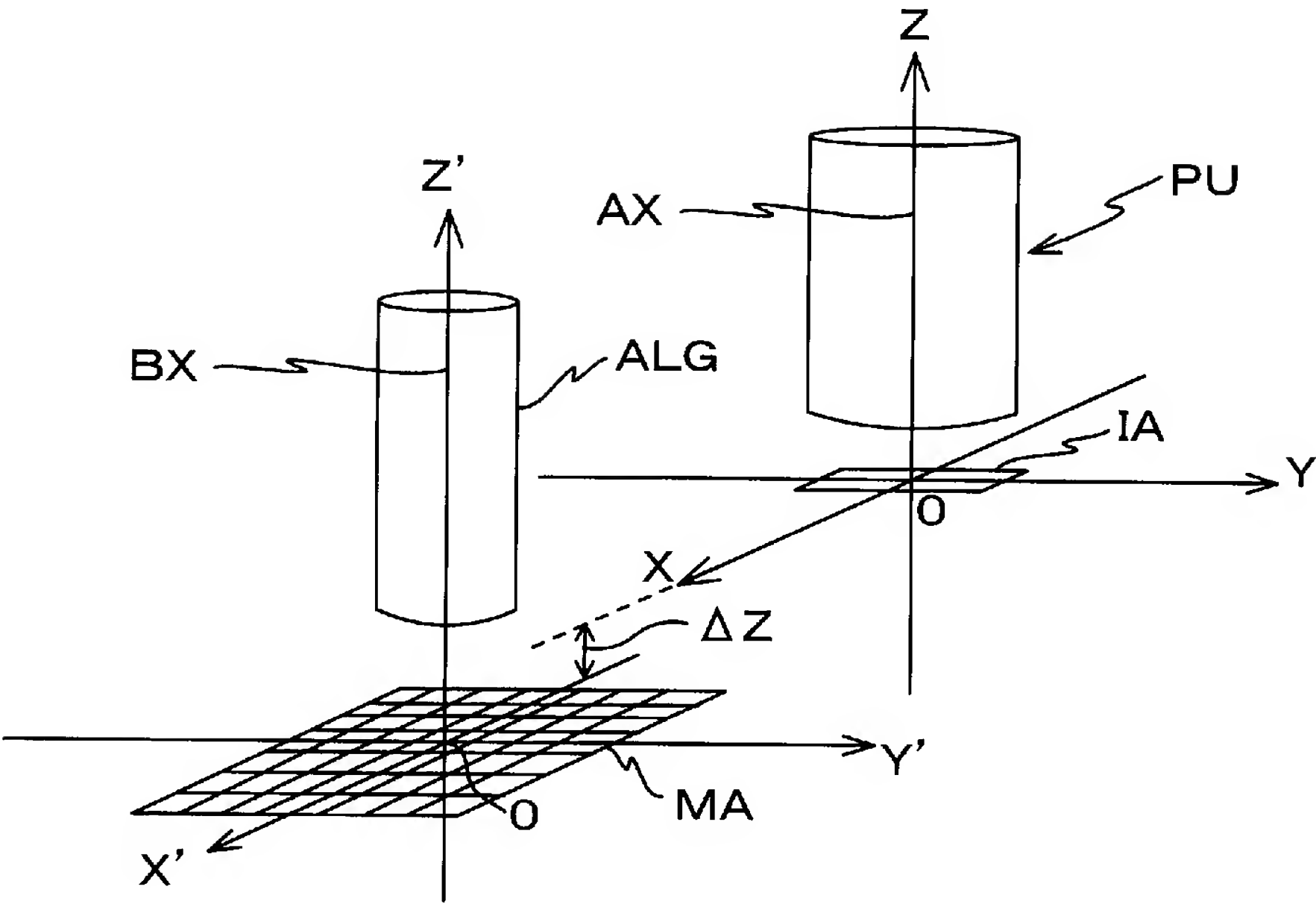
[図6]



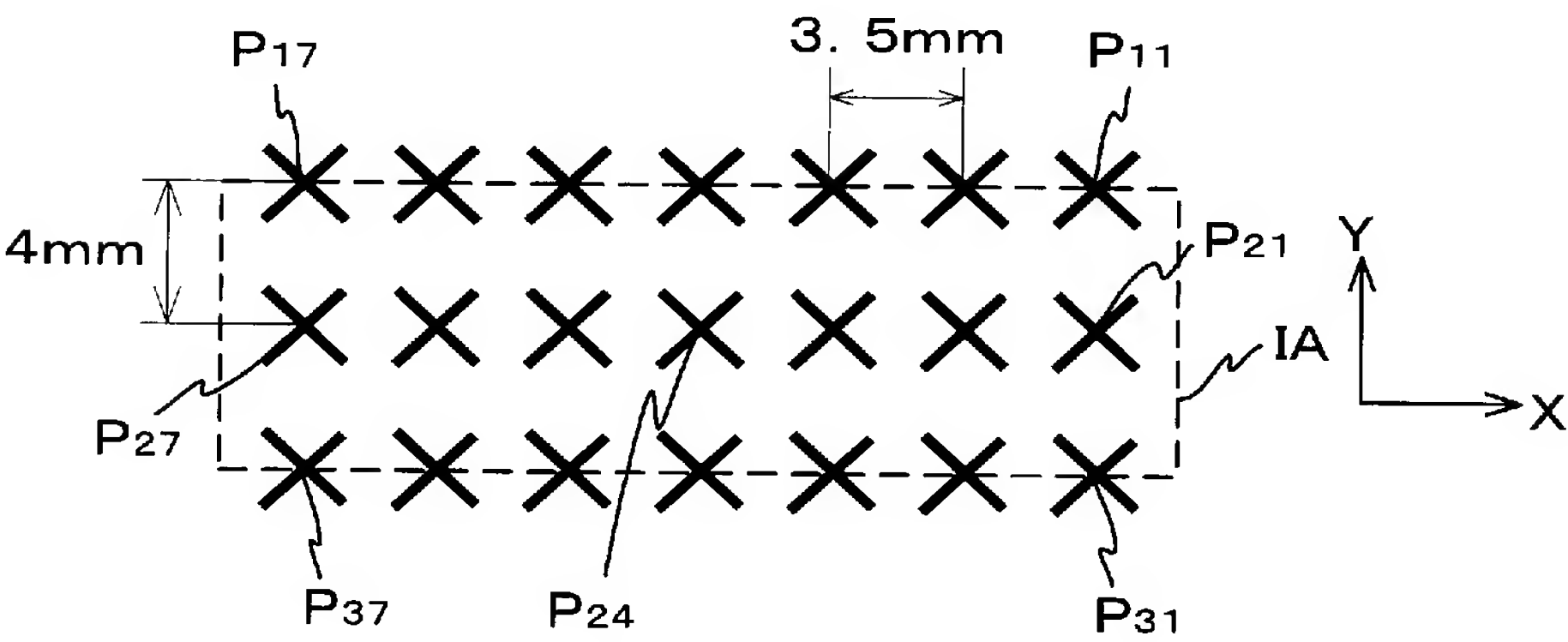
[図7]



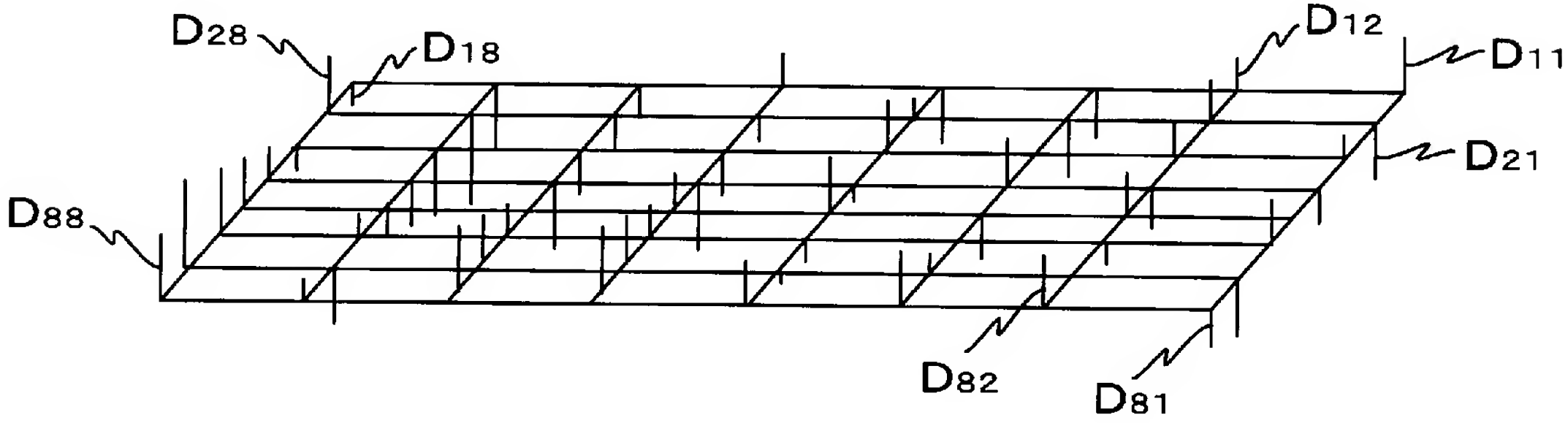
[図8(A)]



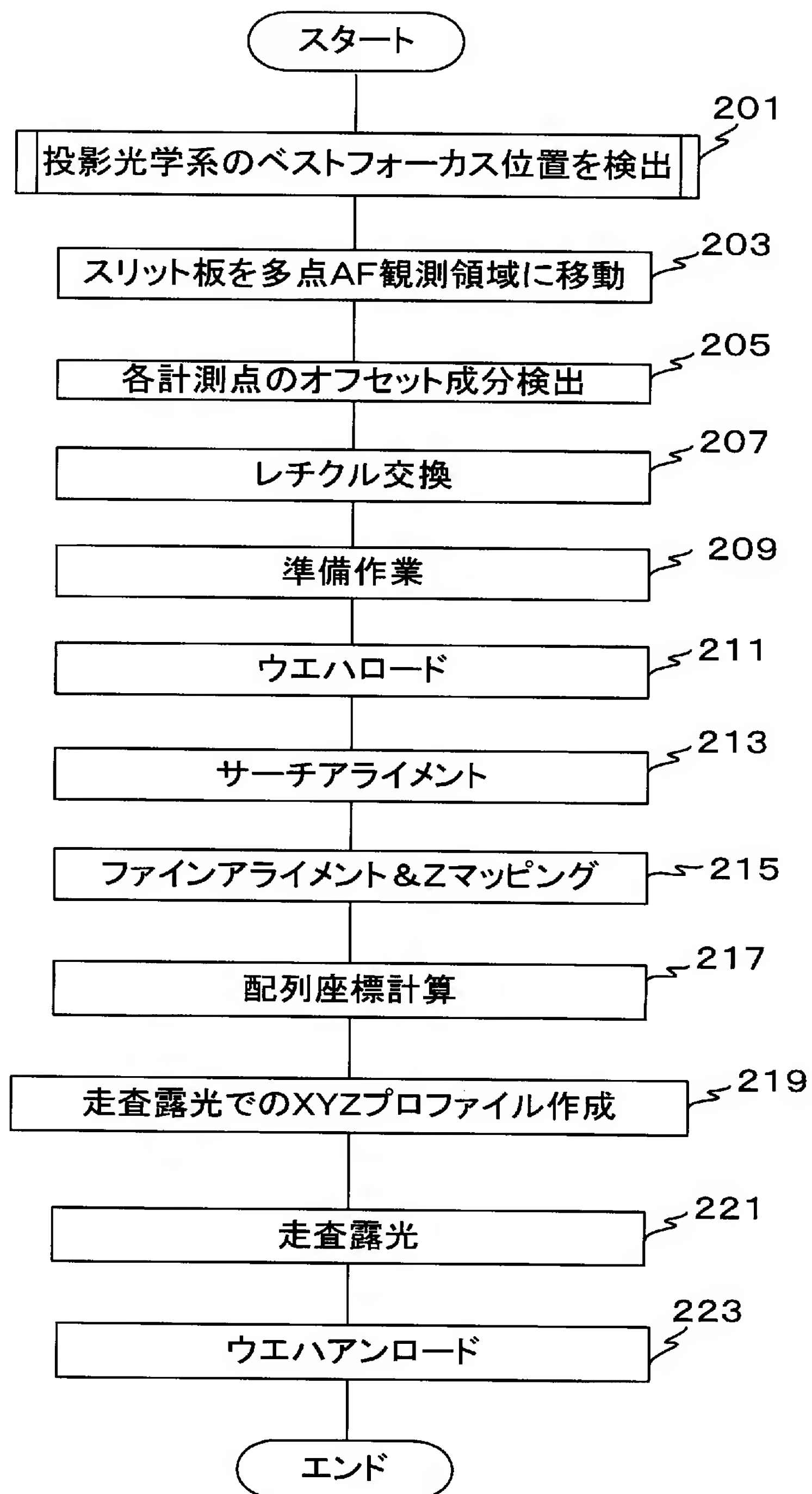
[図8(B)]



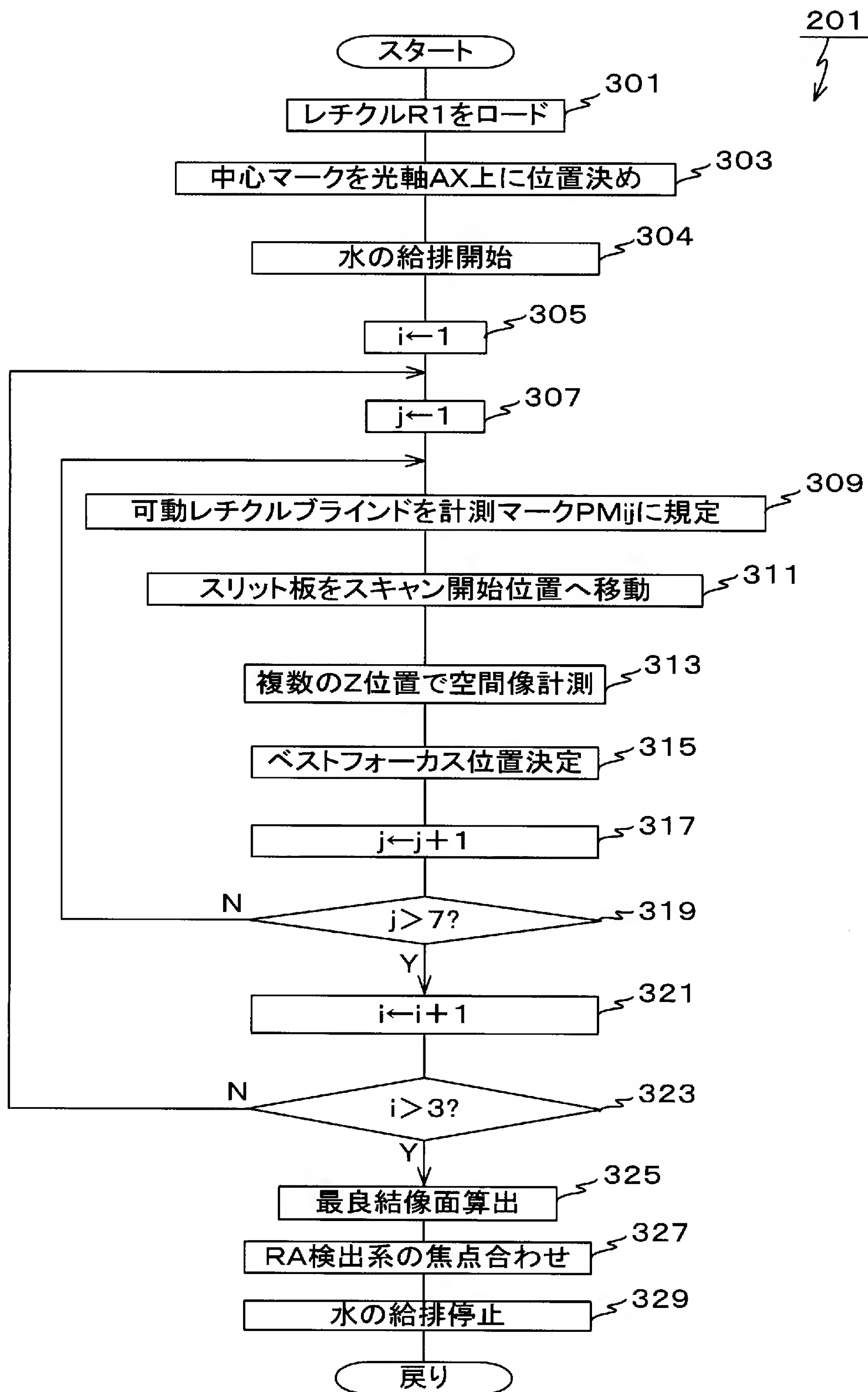
[図8(C)]



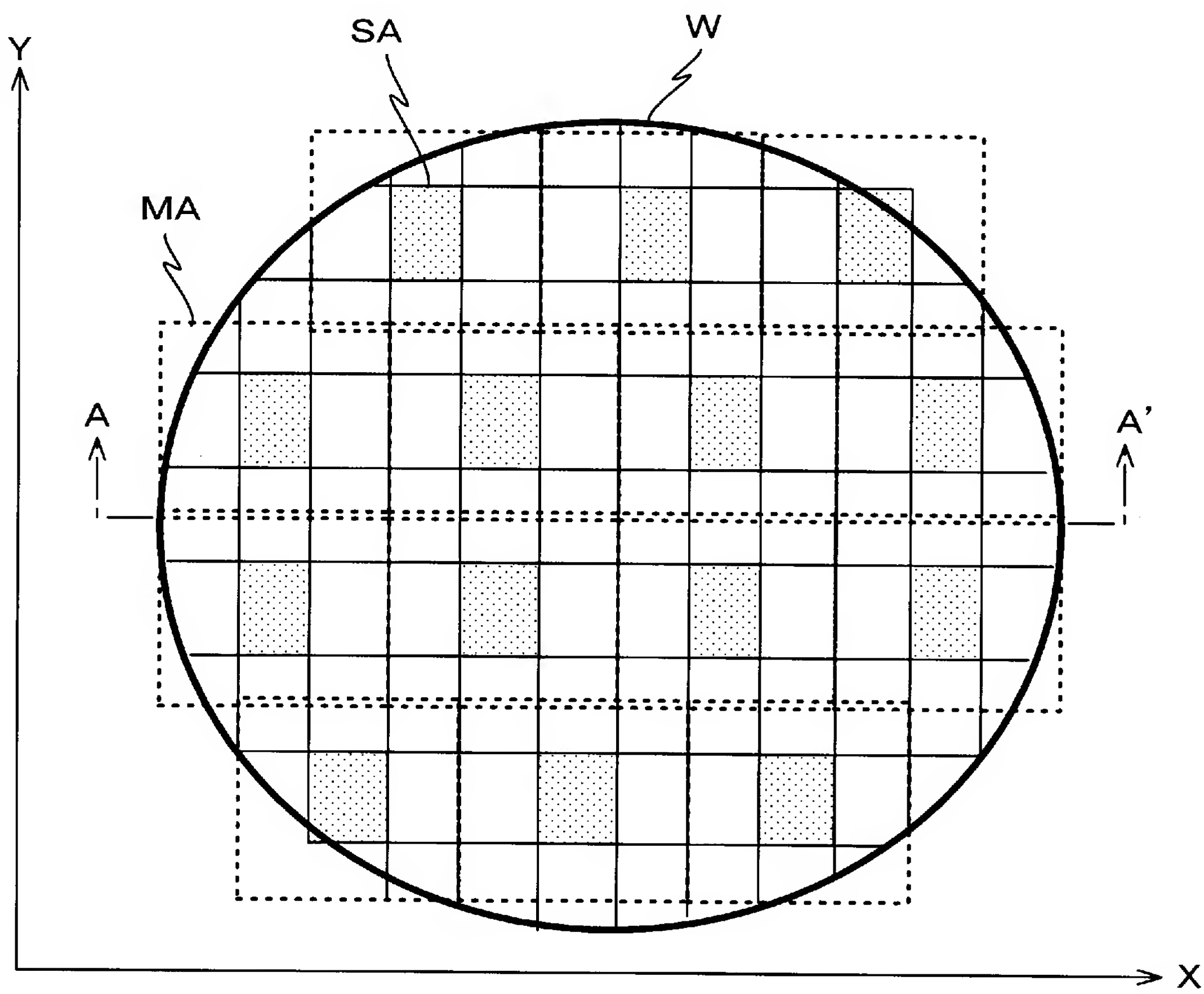
[図9]



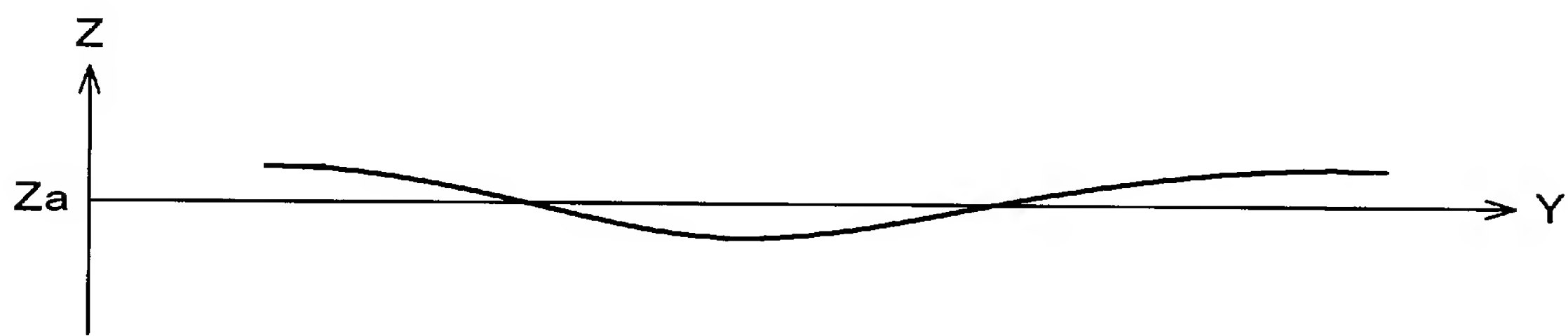
[図10]



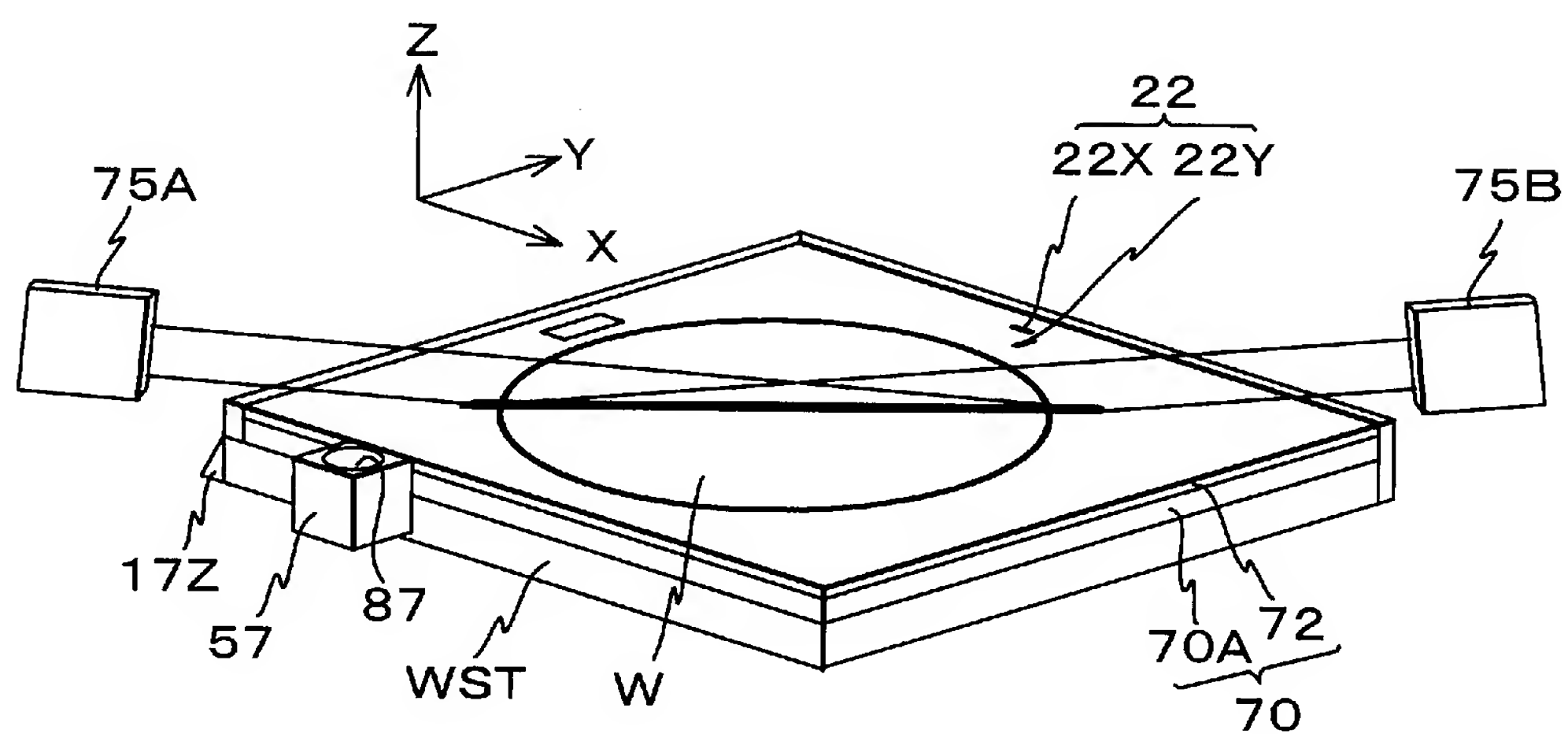
[図11(A)]



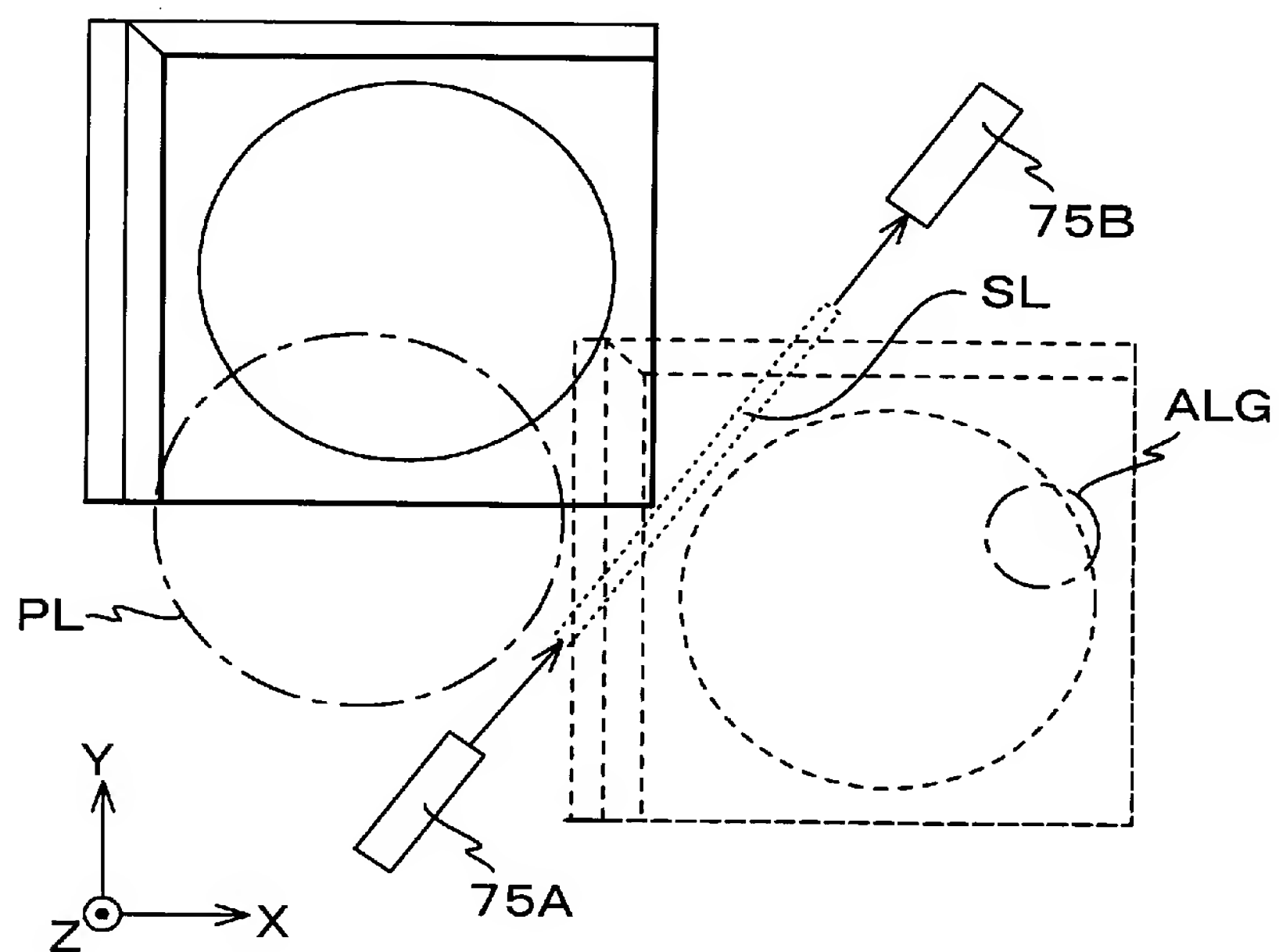
[図11(B)]



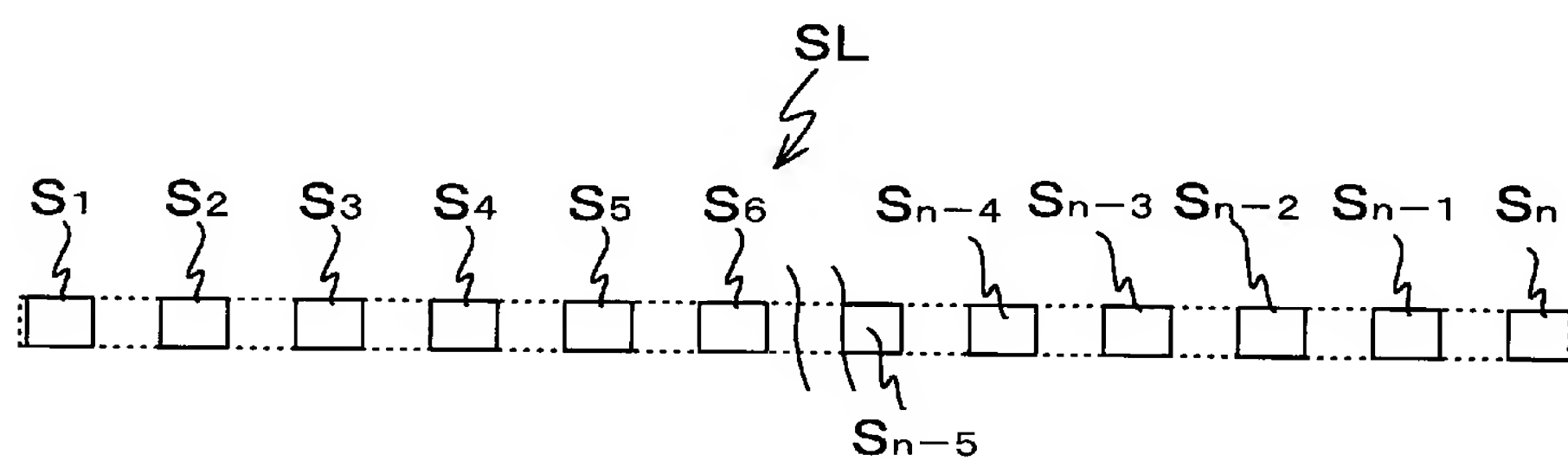
[図12(A)]



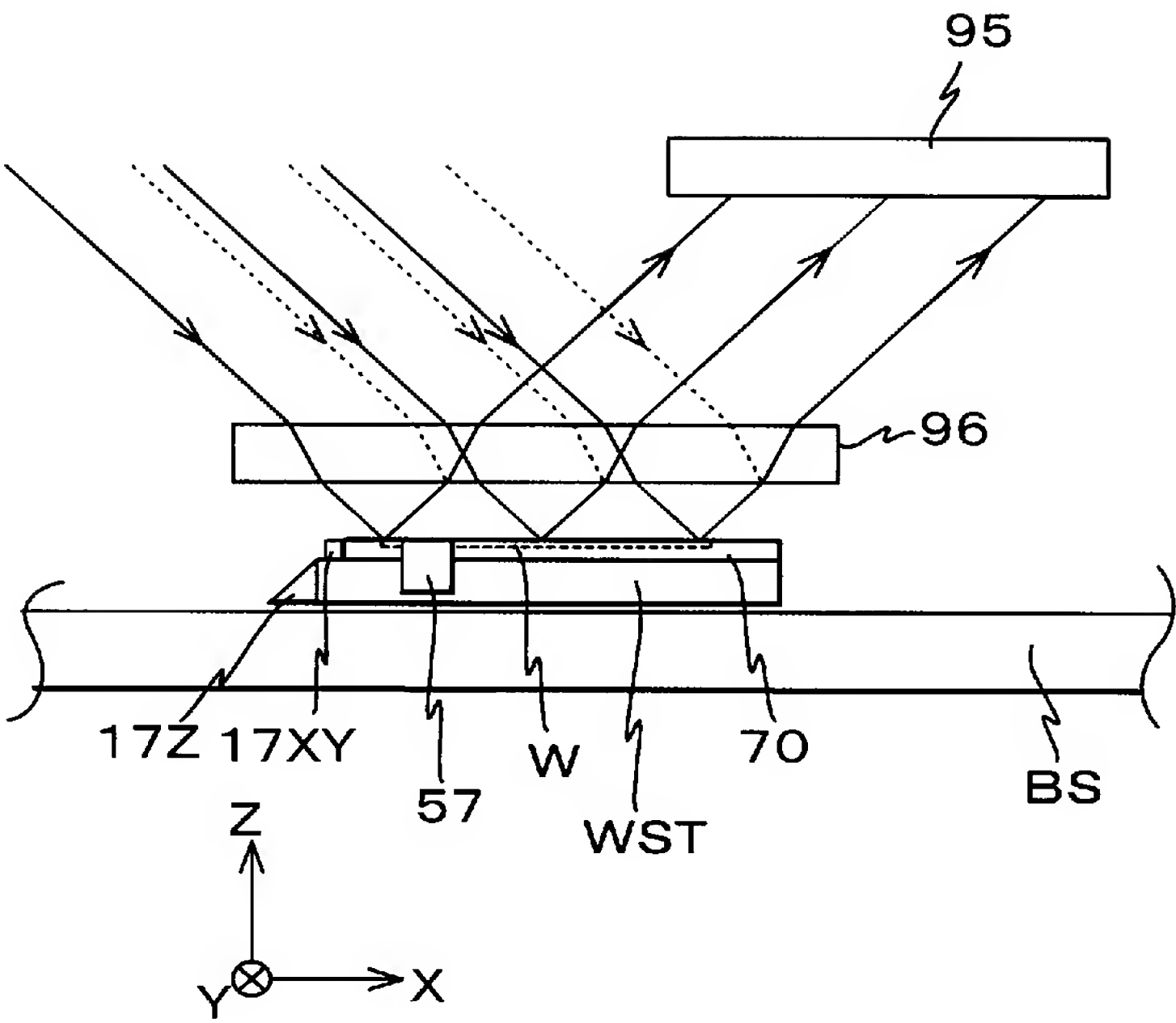
[図12(B)]



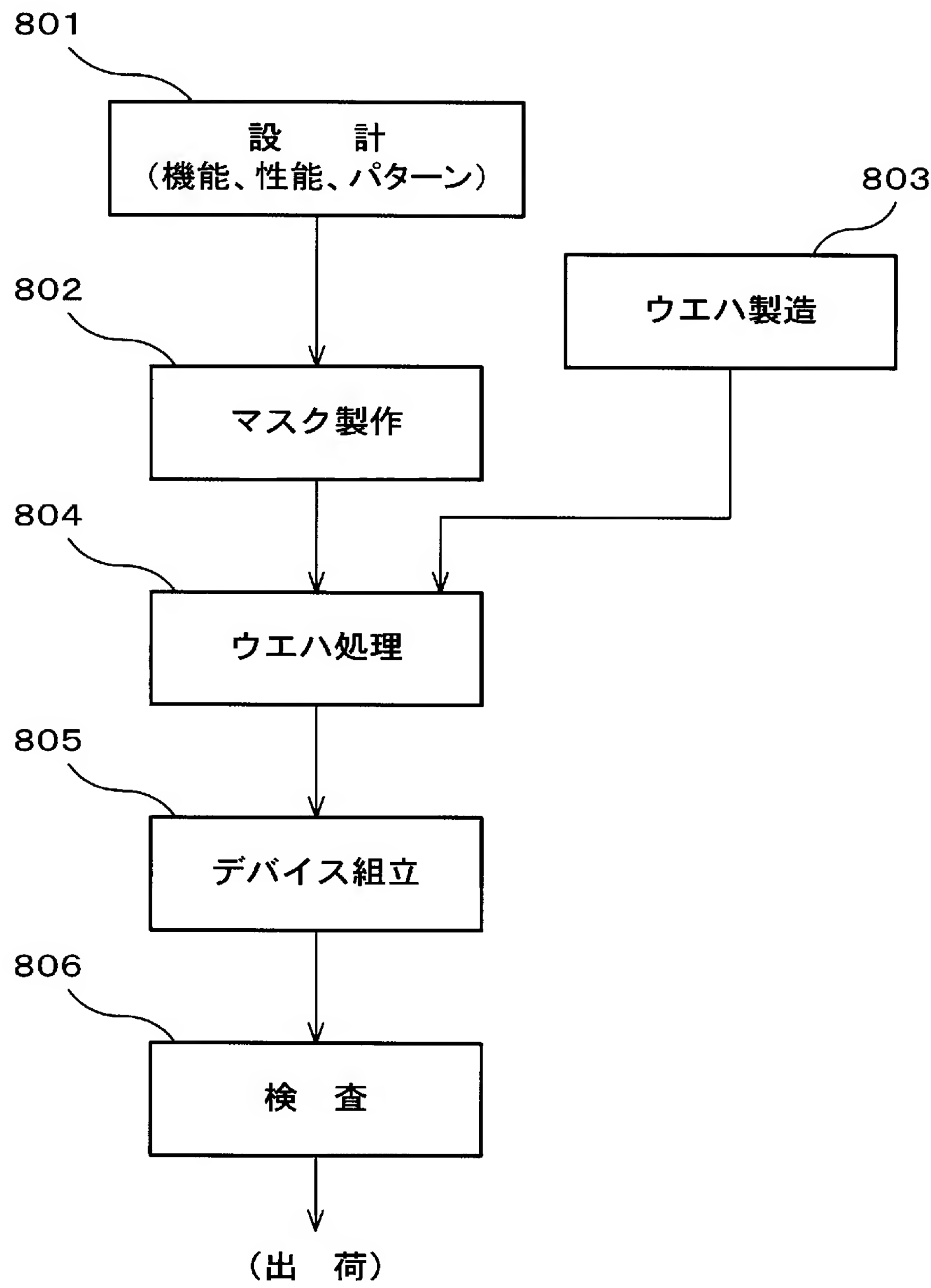
[図12(C)]



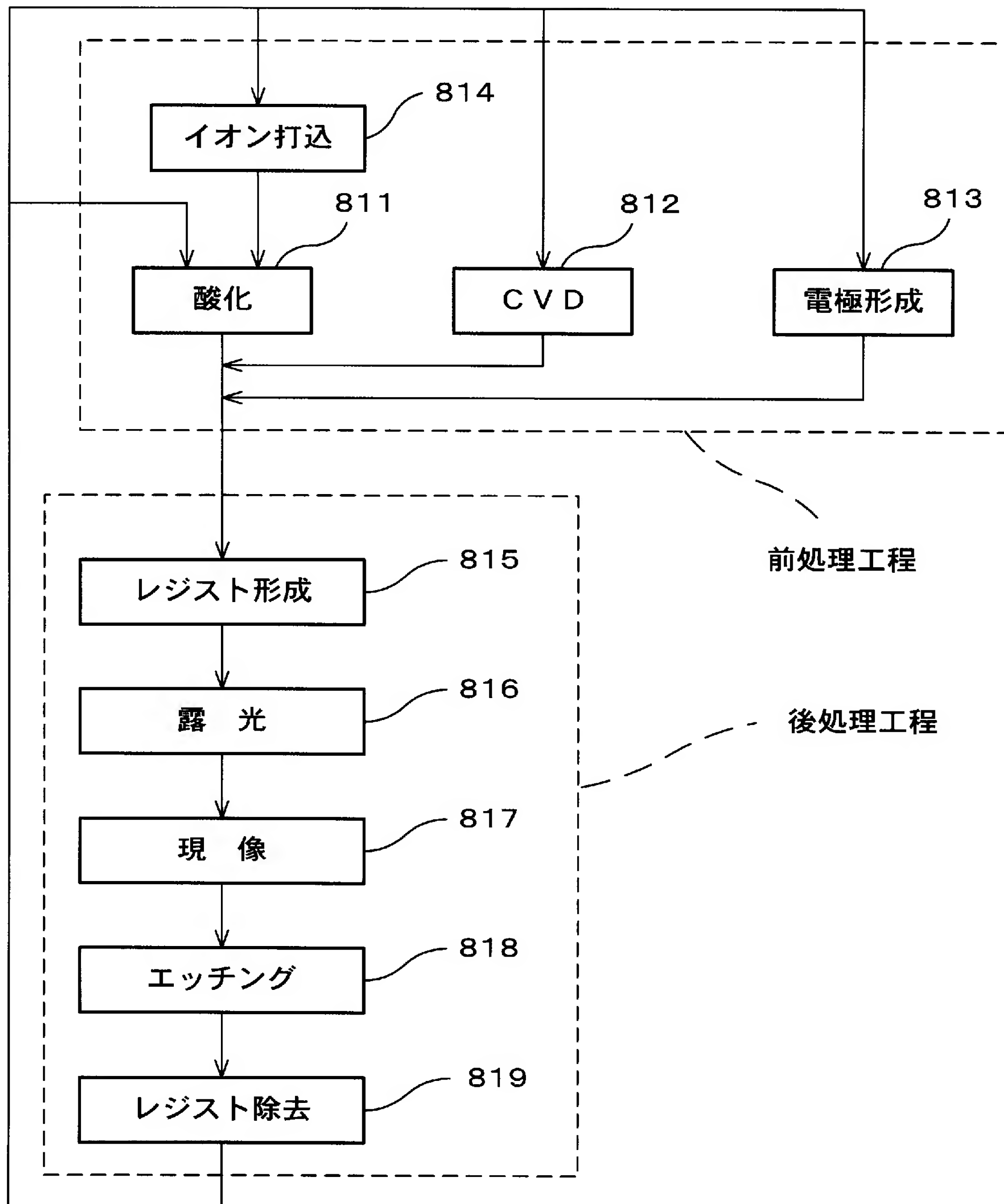
[図13]



[図14]



[図15]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/006071

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl.⁷ H01L21/027, G03F7/20

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.⁷ H01L21/027, G03F7/20

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2004-071851 A (Canon Inc.), 04 March, 2004 (04.03.04), Page 1, Claims; Par. Nos. [0033] to [0034]; Fig. 1	1, 2, 10-13, 15, 16, 18, 20-23, 25-27, 32
Y	(Family: none)	3-9, 14, 17, 19, 24, 28-31
X	JP 2001-223157 A (Canon Inc.), 17 August, 2001 (17.08.01), Page 1, Claims; Par. Nos. [0056] to [0065]; Figs. 1, 2	1, 2, 10-13, 15, 16, 18, 20-23, 25-27, 32
Y	& US 2002/0039178 A1	3-9, 14, 17, 19, 24, 28-31



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T”

later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X”

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y”

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&”

document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 June, 2005 (21.06.05)

Date of mailing of the international search report

05 July, 2005 (05.07.05)

Name and mailing address of the ISA/

Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/006071

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2002-203763 A (Nikon Corp.), 19 July, 2002 (19.07.02), Par. Nos. [0049] to [0064]; Figs. 1, 2 (Family: none)	3, 17
Y	JP 10-214783 A (Nikon Corp.), 11 August, 1998 (11.08.98), Par. Nos. [0079] to [0085], [0134]; Figs. 1, 2, 4 & WO 98/024115 A & EP 951054 A1 & AU 5067898 A	4-6, 19
X Y	JP 9-210629 A (Canon Inc.), 12 August, 1997 (12.08.97), Full text; all drawings & US 5834767 A1	26, 27, 32 7-9, 28-31
A	JP 2004-048009 A (ASML Netherlands B.V.), 12 February, 2004 (12.02.04), Par. No. [0017] & US 2004/0051856 A1 & EP 1380897 A1	14, 24, 28-31
A	JP 2004-086193 A (Nikon Corp.), 18 March, 2004 (18.03.04), Par. No. [0216] (Family: none)	14, 24, 28-31

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl.⁷ H01L21/027, G03F7/20

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl.⁷ H01L21/027, G03F7/20

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2004-071851 A（キヤノン株式会社）2004.03.04 第1ページ、特許請求の範囲、[0033]-[0034]、図1 （ファミリーなし）	1, 2, 10-13, 15, 16, 18, 20- 23, 25-27, 32
Y		3-9, 14, 17, 19, 24, 28-31
X	JP 2001-223157 A（キヤノン株式会社）2001.08.17 第1ページ、特許請求の範囲、[0056]-[0065]、図1, 2 & US 2002/0039178 A1	1, 2, 10-13, 15, 16, 18, 20- 23, 25-27, 32

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

21.06.2005

国際調査報告の発送日

05.7.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

岩本 勉

2M

9355

電話番号 03-3581-1101 内線 3274

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y		3-9, 14, 17, 19, 24, 28-31
Y	JP 2002-203763 A (株式会社ニコン) 2002. 07. 19 [0049]-[0064]、図 1, 2 (ファミリーなし)	3, 17
Y	JP 10-214783 A (株式会社ニコン) 1998. 08. 11 [0079]-[0085]、[0134]、図 1, 2, 4 & WO 98/024115 A & EP 951054 A1 & AU 5067898 A	4-6, 19
X Y	JP 9-210629 A (キヤノン株式会社) 1997. 08. 12 全文、全図 & US 5834767 A1	26, 27, 32 7-9, 28-31
A	JP 2004-048009 A (ASML Netherlands B.V.) 2004. 02. 12 [0017] & US 2004/0051856 A1 & EP 1380897 A1	14, 24, 28-31
A	JP 2004-086193 A (株式会社ニコン) 2004. 03. 18 [0216] (ファミリーなし)	14, 24, 28-31